TPS736 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS、400mA 低压降稳压器

1 特性

- 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
- 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
- 超低压降电压：75mV（典型值）
- 无论是否使用可选输出电容器，均可实现出色的负载瞬态响应
- NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
- 低噪声：30 μ V_{RMS} 典型值（10Hz 至 100kHz）
- 初始精度为 0.5%
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
- 关断模式下 I_Q 最大值小于 1 μ A
- 热关断和指定最小/最大电流限制保护
- 提供了多个输出电压版本：
  - 1.20V 至 5.0V 固定输出
  - 1.20V 至 5.5V 的可调输出
  - 可提供定制输出

2 应用

- 便携式、电池供电类设备
- 适用于开关电源的后置稳压
- 噪声敏感电路（如 VCO）
- 适用于 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节

3 说明

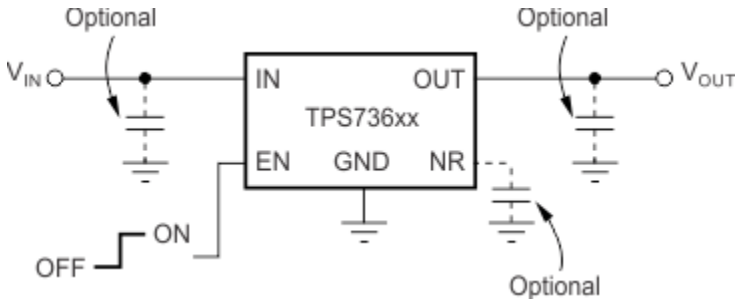
TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构：在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定，甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断（低反向电流）和接地引脚电流（在所有输出电流值范围内几乎保持恒定）。

TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度，同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时，电流消耗低于 1 μ A，非常适合于便携式应用。极低的输出噪声（0.1 μ F C_{NR} 时为 30 μ V_{RMS}）使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

封装信息

器件型号	封装(1)	封装尺寸(2)
TPS736	DBV（SOT-23，5）	2.9mm × 2.8mm
	DCQ（SOT-223，6）	6.5mm × 7.06mm
	DRB（VSON，8）	3mm × 3mm

(1) 如需更多信息，请参阅*机械、封装和可订购信息*。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。



针对固定电压版本的典型应用电路

内容

1 特性 1
2 应用 1
3 说明 1
4 引脚配置和功能 3
5 规格 4
5.1 绝对最大额定值 4
5.2 ESD 等级 4
5.3 建议运行条件 4
5.4 热性能信息 4
5.5 热性能信息 5
5.6 电气特性 6
5.7 典型特性 7
6 详细说明 16
6.1 概述 16
6.2 功能方框图 16
6.3 特性说明 17
6.4 器件功能模式 18
7 应用和实施 19
7.1 应用信息 19
7.2 典型应用 19
7.3 电源相关建议 24
7.4 布局 24
8 器件和文档支持 28
8.1 器件支持 28
8.2 文档支持 28
8.3 接收文档更新通知 28
8.4 支持资源 28
8.5 商标 28
8.6 静电放电警告 28
8.7 术语表 29
9 修订历史记录 29
10 机械、封装和可订购信息 29

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

4 引脚配置和功能

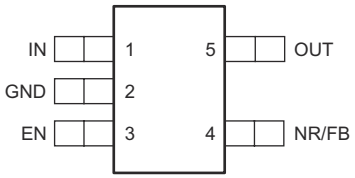


图 4-1. DBV 封装，5 引脚 SOT-23（顶视图）

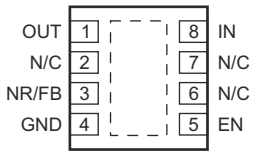


图 4-2. DRB 封装，8 引脚 VSON（俯视图）

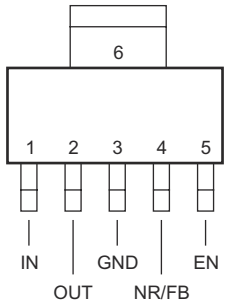


图 4-3. DCQ 封装，6 引脚 SOT-223（顶视图）

表 4-1. 引脚功能

引脚				类型[1]	说明
名称	编号				
	SOT-23	SOT-223	VSON		
EN	3	5	5	I	驱动使能引脚 (EN) 为高电平打开稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。更多详细信息，请参阅*使能引脚和关断*部分。如未使用，EN 可被连接至 IN。
FB	4	4	3	I	仅限可调电压版本。该引脚为控制环路误差放大器提供输入，并可用于设定器件的输出电压。
GND	2	3、6	4，焊盘	—	接地。
IN	1	1	8	I	输入电源。
NR	4	4	3	—	仅限固定电压版本。将一个外部电容器连接到这个降噪引脚来绕开内部带隙生成的噪声，同时将输出噪声降到极低水平。
OUT	5	2	1	O	稳压器的输出。无需外部电容器实现此稳定性。

(1) I = 输入；O = 输出

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作结温范围内测得（除非另有说明）(1)

		最小值	最大值	单位
电压	输入，V_{IN}	-0.3	6	V
	使能，V_{EN}	-0.3	6	
	输出，V_{OUT}	-0.3	5.5	
	V_{NR}、V_{FB}	-0.3	6	
电流	最大输出，I_{OUT}	受内部限制		
输出短路持续时间		未确定		
持续总功率耗散	P_{DISS}	请参阅*热性能信息*		
温度	工作结温，T_J	-55	150	°C
	贮存温度，T_{stg}	-65	150	

(1) 在*绝对最大额定值*范围外运行可能会对器件造成永久损坏。*绝对最大额定值*并不表示器件在这些条件下或在*建议的工作条件*以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出*建议运行条件*但在*绝对最大额定值*范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚(1)	±2000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101，所有引脚(2)	±500	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在工作结温范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
V_{IN}	输入电源电压	1.7		5.5	V
I_{OUT}	输出电流	0		400	mA
T_J	工作结温	-40		125	°C

5.4 热性能信息

热指标(1)		TPS736 新器件			单位
		DRB (VSON)	DCQ (SOT-223)	DBV (SOT-23)	
		8 引脚	6 引脚	5 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	49.4	76	185.2	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	76.6	46.6	82.9	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	22.0	18.1	53.1	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	3.8	8.6	21.1	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	22.0	17.6	52.7	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	3.8	不适用	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅半导体和 IC 封装热指标应用手册。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5.5 热性能信息

热指标(1) (2)		TPS736 传统器件(3)			单位
		DRB (VSON)	DCQ (SOT-223)	DBV (SOT-23)	
		8 引脚	6 引脚	5 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻(4)	52.8	118.7	221.9	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻(5)	60.4	64.9	74.9	°C/W
$R_{\theta JB}$	结到电路板热阻(6)	28.4	65.0	51.9	°C/W
ψ_{JT}	结到顶部的表征参数(7)	2.1	14.0	2.8	°C/W
ψ_{JB}	结到电路板的表征参数(8)	28.6	63.8	51.1	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结到芯片外壳（底部）热阻(9)	12.0	不适用	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅半导体和 IC 封装热指标应用手册。
(2) 如需根据 PCB 覆铜区对该器件进行热量估算，请参阅 TI PCB 热量计算器。
(3) DRB、DCQ 和 DBV 封装的热数据是根据 JESD51 系列中指定的 JEDEC 标准方法进行热仿真得出的。仿真时使用了以下假设：
(a) i. DRB：外露焊盘通过 2x2 散热过孔阵列连接到 PCB 接地层。
ii.DCQ：外露焊盘通过 3x2 散热过孔阵列连接到 PCB 接地层。
iii.DBV：DBV 封装没有外露焊盘。
(b) i. DRB：假设顶部和底部铜层的导热率为铜的 20%，表示铜覆盖率为 20%。
ii.DCQ：每个顶部和底部铜层都有一个专用图案，可实现 20% 的铜覆盖。
iii.DBV：假设顶部和底部铜层的导热率为铜的 20%，表示铜覆盖率为 20%。
(c) 这些数据生成时只有一个器件位于 JEDEC 高 K (2s2p) 电路板的中心，覆铜区为 3 英寸 × 3 英寸。要了解覆铜区对热性能的影响，请参阅本数据表的“功率耗散”部分。
(4) 在 JESD51-2a 描述的环境中，按照 JESD51-7 的规定，在一个 JEDEC 标准高 K 电路板上进行仿真，从而获得自然对流条件下的结至环境热阻抗。
(5) 通过在封装顶部模拟一个冷板测试来获得结至芯片外壳（顶部）的热阻。不存在特定的 JEDEC 标准测试，但可在 ANSI SEMI 标准 G30-88 中找到内容接近的说明。
(6) 结至板热阻，可按照 JESD51-8 中的说明在使用环形冷板夹具来控制 PCB 温度的环境中进行仿真来获得。
(7) 结至顶部特征参数 ψ_{JT} 估算器件在实际系统中的结温，可通过 JESD51-2a（第 6 节和第 7 节）介绍的步骤从获得 $R_{\theta JA}$ 的仿真数据中获取该温度。
(8) 结至电路板特征参数 ψ_{JB} 估算器件在实际系统中的结温，可通过 JESD51-2a（第 6 节和第 7 节）介绍的步骤从获得 $R_{\theta JA}$ 的仿真数据中获取该温度。
(9) 通过在外露（电源）焊盘上进行冷板测试仿真来获得结至芯片外壳（底部）热阻。不存在特定的 JEDEC 标准测试，但可在 ANSI SEMI 标准 G30-88 中找到内容接近的说明。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5.6 电气特性

在工作温度范围（T_J = –40°C 至 125°C）、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V(1) 、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。典型值为 T_J = 25°C 条件下的值。

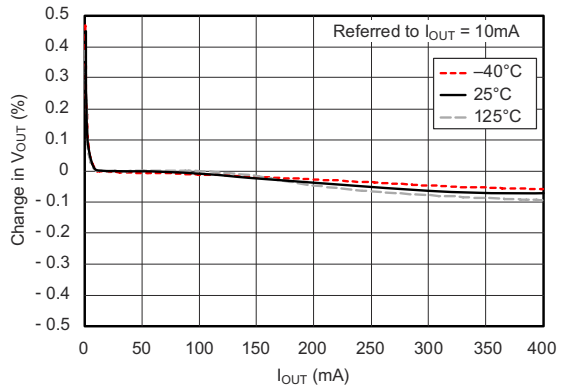
参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压范围(1) (2)			1.7		5.5	V
V_{FB}	内部基准 (TPS73601)	T_J = 25°C		1.198	1.204	1.210	V
V_{OUT}	输出电压范围 (TPS73601)(3)			V_{FB}		5.5 - V_{DO}	V
	准确度(1) (4)	标称值	T_J = 25°C	-0.5		0.5	%
		在 V_{IN}、I_{OUT} 且 T 条件下	V_{OUT} + 0.5V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V；10mA ≤ I_{OUT} ≤ 400mA	-1	±0.5	1	
$\Delta V_{OUT(\Delta VIN)}$	线性调整率 (1)	$V_{OUT(nom)}$ + 0.5V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V			0.01		%/V
$\Delta V_{OUT(\Delta IOUT)}$	负载调整率	1mA ≤ I_{OUT} ≤ 400mA			0.002		%/mA
		10mA ≤ I_{OUT} ≤ 400mA			0.0005		
V_{DO}	压降电压(5) (V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ - 0.1V)	I_{OUT} = 400mA			75	200	mV
$Z_{O(DO)}$	压降中的输出阻抗	1.7V ≤ V_{IN} ≤ V_{OUT} + V_{DO}			0.25		Ω
I_{CL}	输出电流限制	V_{OUT} = 0.9 × $V_{OUT(nom)}$	传统器件	400	650	800	mA
		3.6V ≤ V_{IN} ≤ 4.2V，0℃ ≤ T_J ≤ 70℃		500		800	
		V_{OUT} = 0.9 × $V_{OUT(nom)}$	新器件	500		800	
I_{SC}	短路电流	V_{OUT} = 0V			450		mA
I_{REV}	反向漏电流(6) ($-I_{IN}$)	V_{EN} ≤ 0.5V，0V ≤ V_{IN} ≤ V_{OUT}			0.1	10	µA
I_{GND}	接地引脚电流	I_{OUT} = 10mA (I_Q)，传统器件			400	550	µA
		I_{OUT} = 10mA (I_Q)，新器件			400	630	
I_{GND}	接地引脚电流	I_{OUT} = 400mA			800	1000	µA
I_{SHDN}	关断电流 (I_{GND})	V_{EN} ≤ 0.5V，V_{OUT} ≤ V_{IN} ≤ 5.5V，–40°C ≤ T_J ≤ 100℃，传统器件			0.02	1	µA
		V_{EN} ≤ 0.5V，V_{OUT} ≤ V_{IN} ≤ 5.5V，新器件			0.02	1	
I_{FB}	反馈引脚电流 (TPS73601)				0.1	0.3	µA
PSRR	电源抑制比（纹波抑制）	f = 100Hz，I_{OUT} = 400mA			58		dB
		f = 10kHz，I_{OUT} = 400mA			37		
V_N	输出噪声电压，BW = 10Hz 至 100kHz	C_{OUT} = 10µF，无 C_{NR}			27 × V_{OUT}		μV_{RMS}
		C_{OUT} = 10µF，C_{NR} =0.01µF			8.5 × V_{OUT}		
t_{STR}	启动时间	V_{OUT} = 3V，R_L = 30 Ω，C_{OUT} = 1 µF，C_{NR} = 0.01 µF			600		µs
$V_{EN(high)}$	EN 引脚高电平（已使能）			1.7		V_{IN}	V
$V_{EN(low)}$	EN 引脚低电平（关断）			0		0.5	V
$I_{EN(high)}$	使能引脚电流（已使能）	V_{EN} = 5.5V			0.02	0.1	µA
T_{SD}	热关断温度	关断，温度升高			160		°C
		复位，温度降低			140		
T_J	工作结温			-40		125	℃

(1) 最小 V_{IN} = V_{OUT} + V_{DO} 或者 1.7V，以较大者为准。
(2) 对于 $V_{OUT(nom)}$ < 1.6V，当 V_{IN} ≤ 1.6V 时，输出锁定到 V_{IN} 并可能导致输出上出现破坏性过压情况。为避免这种情况，请先禁用器件，然后再将 V_{IN} 关断。（仅限传统器件）
(3) TPS73601 在 V_{OUT} = 2.5V 条件下进行测试。
(4) 外部电阻器的耐受电压不包括在这个技术规范中。
(5) 针对输出版本，不在 $V_{OUT(nom)}$ < 1.8V 时测量 V_{DO}，这是因为最小 V_{IN} = 1.7V。
(6) 只适用于固定电压版本；更多信息请参考*应用信息*部分。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

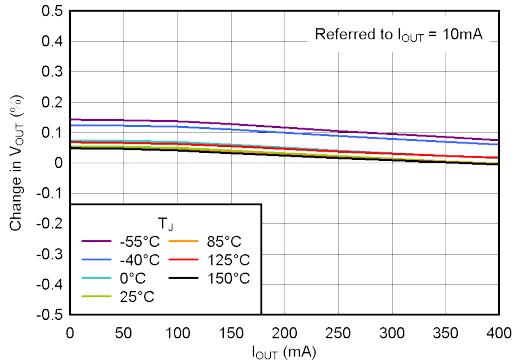
5.7 典型特性

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。



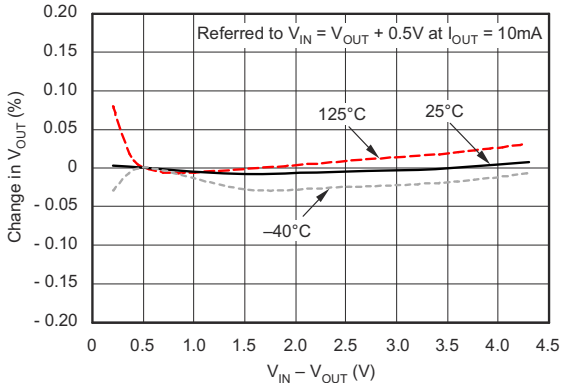
传统器件

图 5-1. 负载调整率



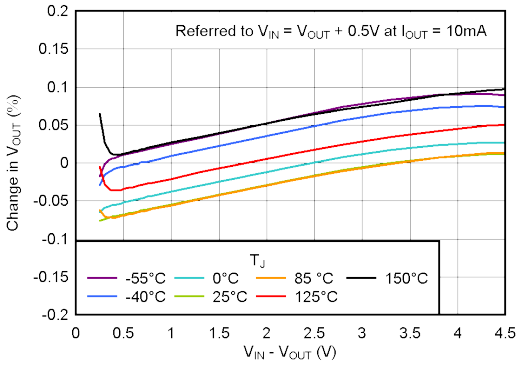
新器件

图 5-2. 负载调整率



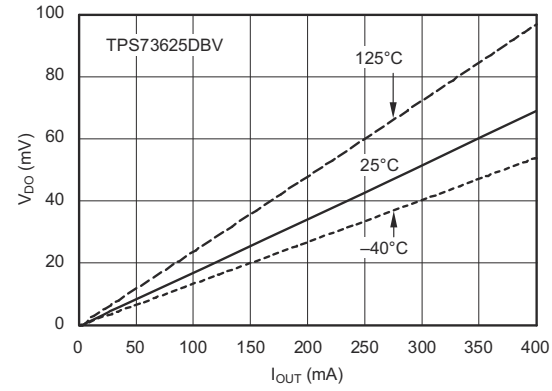
传统器件

图 5-3. 线路调整



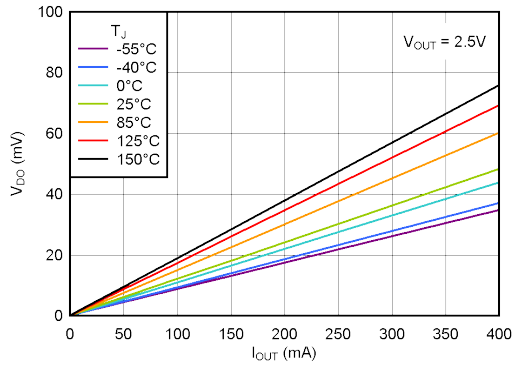
新器件

图 5-4. 线路调整



传统器件

图 5-5. 压降电压与输出电流间的关系



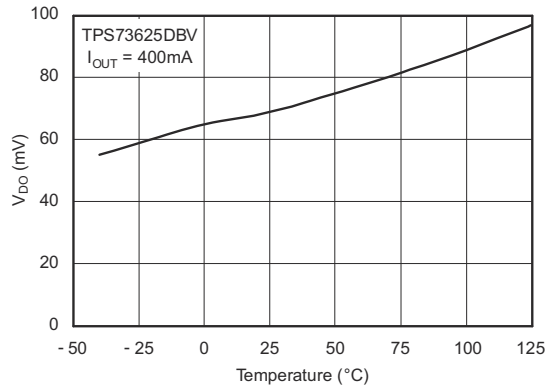
新器件

图 5-6. 压降电压与输出电流间的关系

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

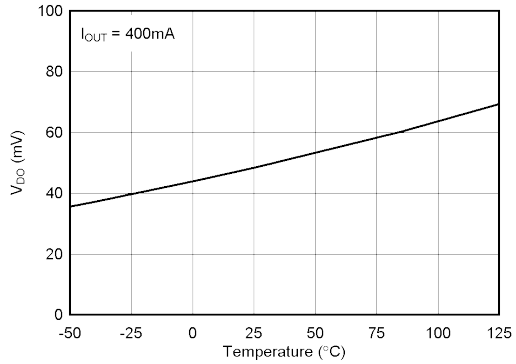
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。



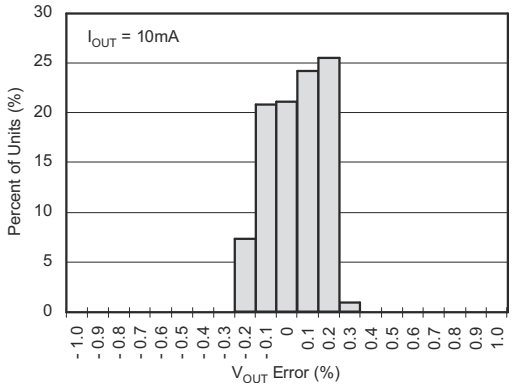
传统器件

图 5-7. 压降电压与温度间的关系



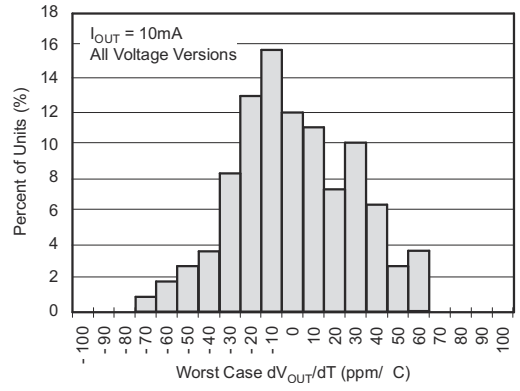
新器件

图 5-8. 压降电压与温度间的关系



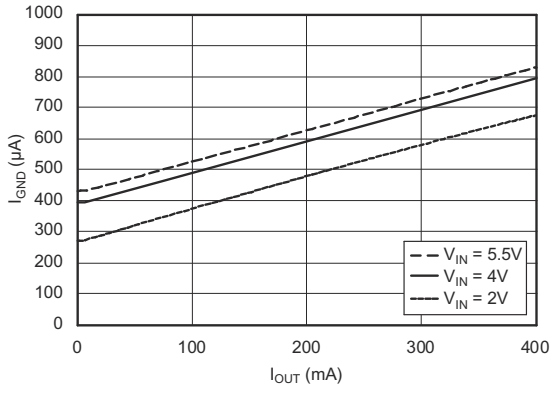
传统器件

图 5-9. 输出电压精度柱状图



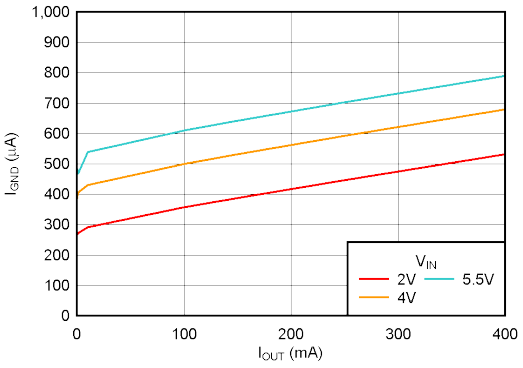
传统器件

图 5-10. 输出电压漂移柱状图



传统器件

图 5-11. 接地引脚电流与输出电流间的关系



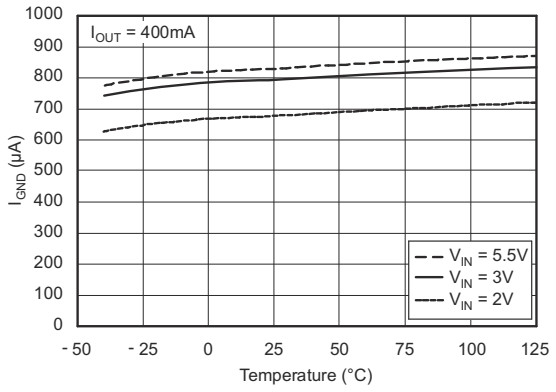
新器件

图 5-12. 接地引脚电流与输出电流间的关系

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

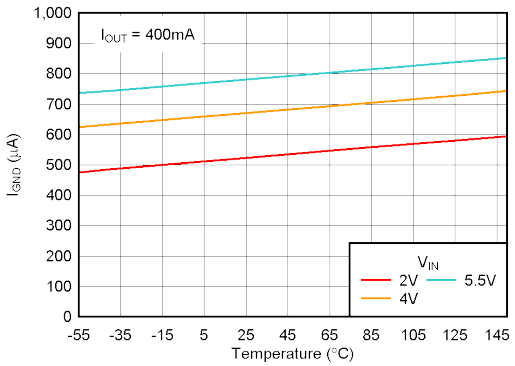
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。



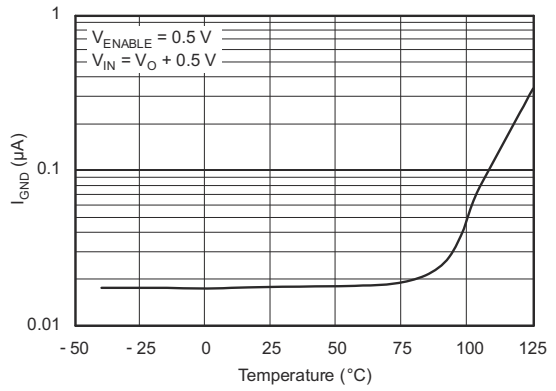
传统器件

图 5-13. 接地引脚电流与温度间的关系



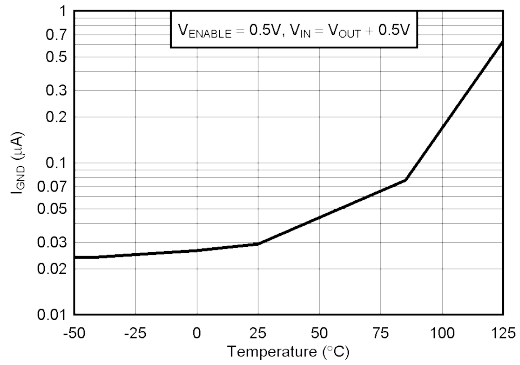
新器件

图 5-14. 接地引脚电流与温度间的关系



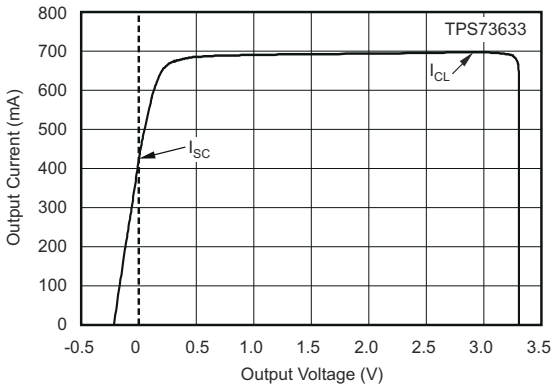
传统器件

图 5-15. 关断时的接地引脚电流与温度间的关系



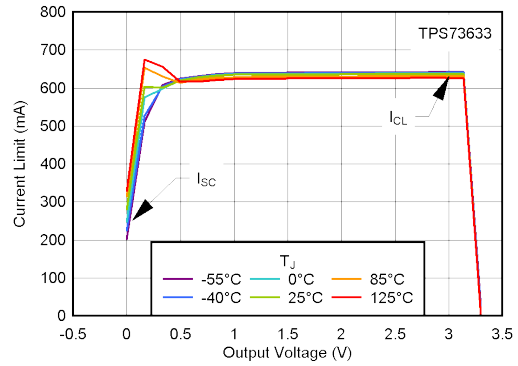
新器件

图 5-16. 关断时的接地引脚电流与温度间的关系



传统器件

图 5-17. 电流限值与 V_{OUT}（折返）间的关系



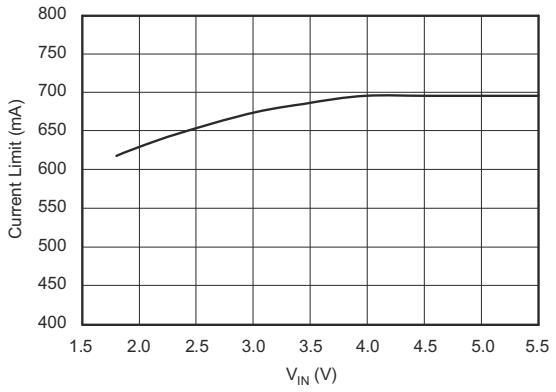
新器件

图 5-18. 电流限值与 V_{OUT}（折返）间的关系

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

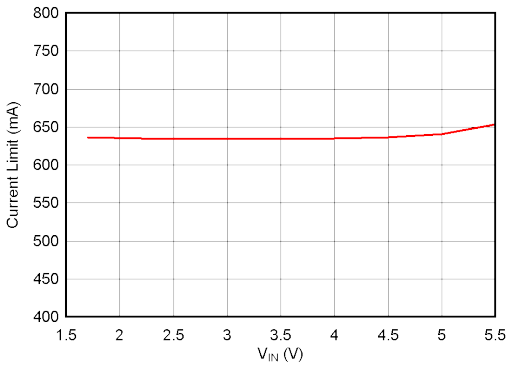
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。



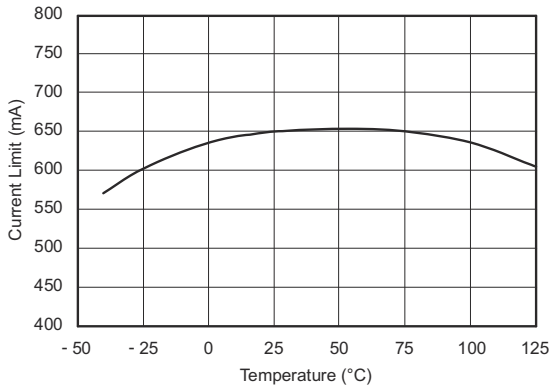
传统器件

图 5-19. 电流限值与 V_{IN} 间的关系



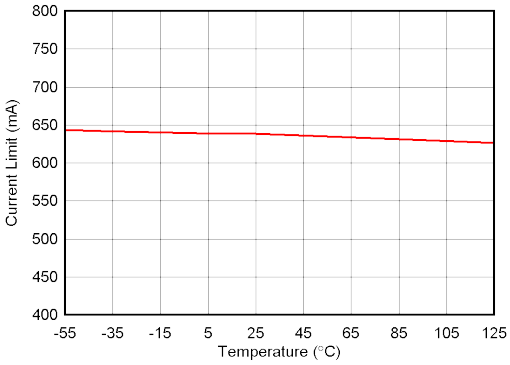
新器件

图 5-20. 电流限值与 V_{IN} 间的关系



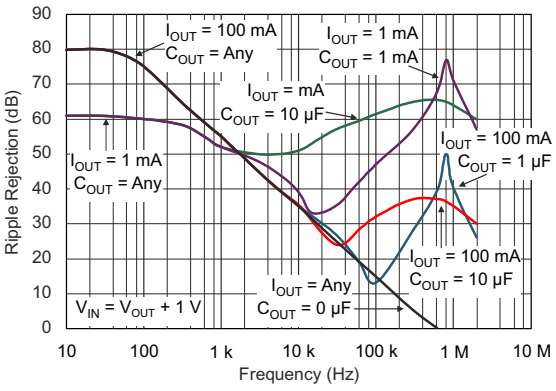
传统器件

图 5-21. 电流限制与温度间的关系



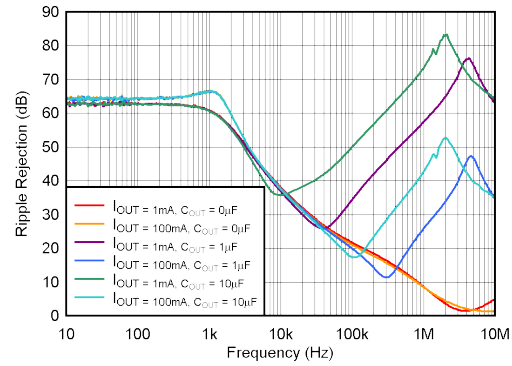
新器件

图 5-22. 电流限制与温度间的关系



传统器件

图 5-23. PSRR（纹波抑制）与频率间的关系



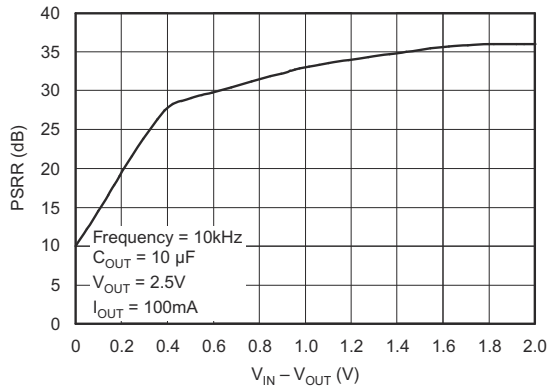
新器件

图 5-24. PSRR（纹波抑制）与频率间的关系

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

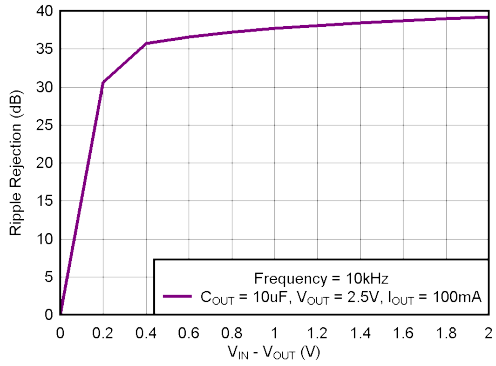
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µ F 条件下（除非另有说明）。



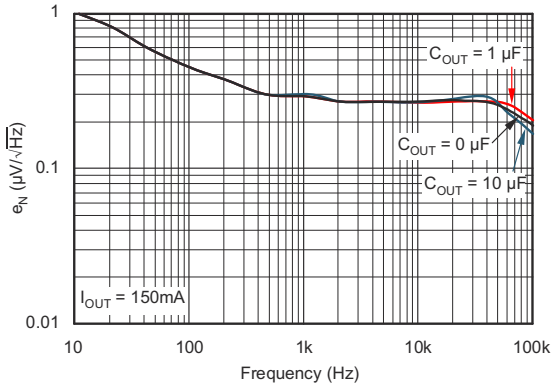
传统器件

图 5-25. PSRR（纹波抑制）与 V_{IN} – V_{OUT} 间的关系



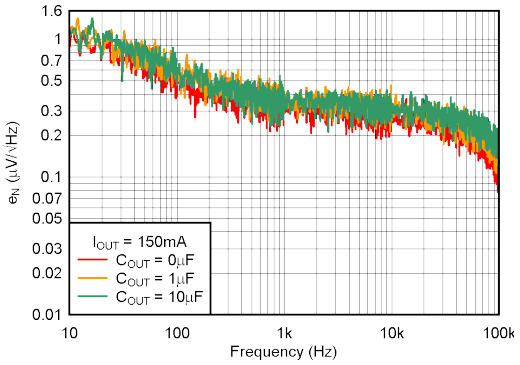
新器件

图 5-26. PSRR（纹波抑制）与 V_{IN} – V_{OUT} 间的关系



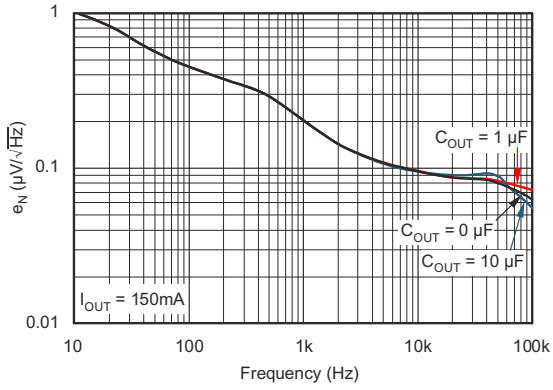
传统器件

图 5-27. 噪声谱密度 C_{NR} = 0 µ F



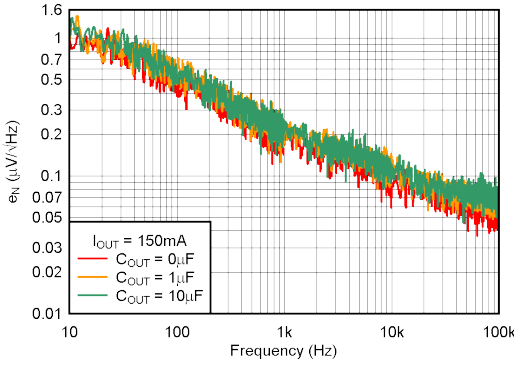
新器件

图 5-28. 噪声谱密度 C_{NR} = 0 µ F



传统器件

图 5-29. 噪声谱密度 C_{NR} = 0.01 µ F



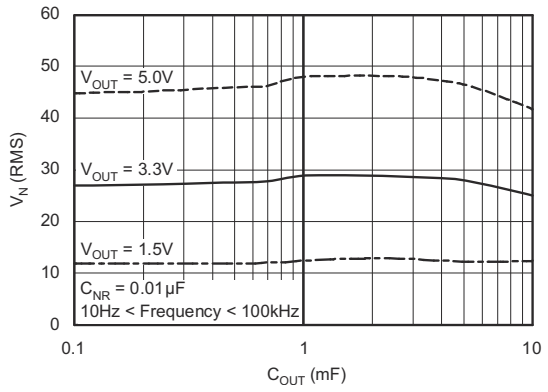
新器件

图 5-30. 噪声谱密度 C_{NR} = 0.01 µ F

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

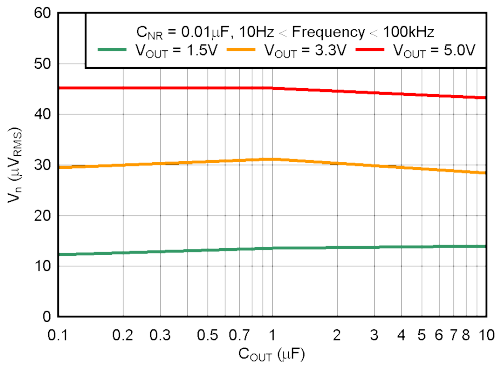
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。



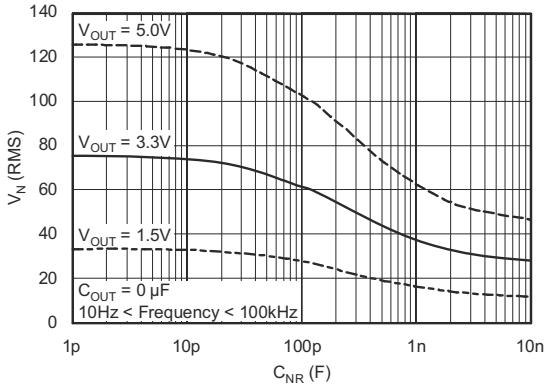
传统器件

图 5-31. RMS 噪声电压与 C_{OUT} 间的关系



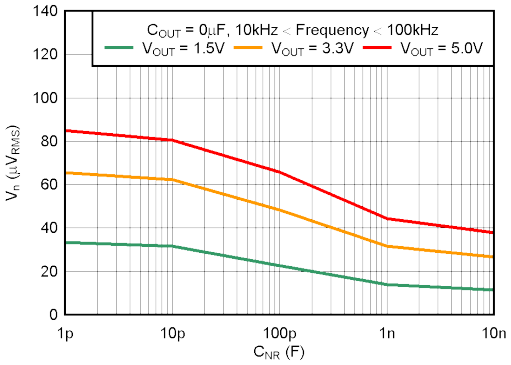
新器件

图 5-32. RMS 噪声电压与 C_{OUT} 间的关系



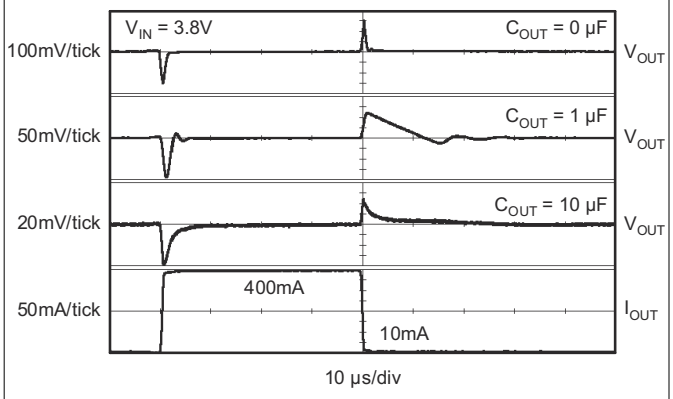
传统器件

图 5-33. RMS 噪声电压与 C_{NR} 间的关系



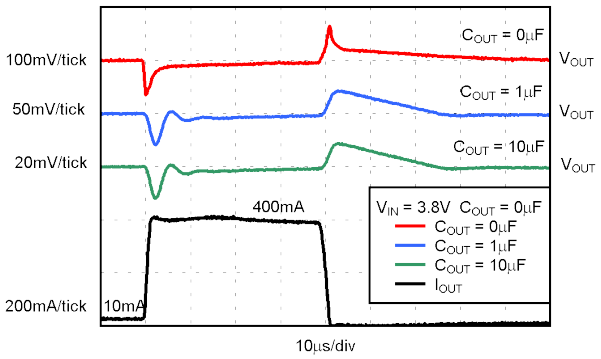
新器件

图 5-34. RMS 噪声电压与 C_{NR} 间的关系



传统器件

图 5-35. TPS73633 负载瞬态响应



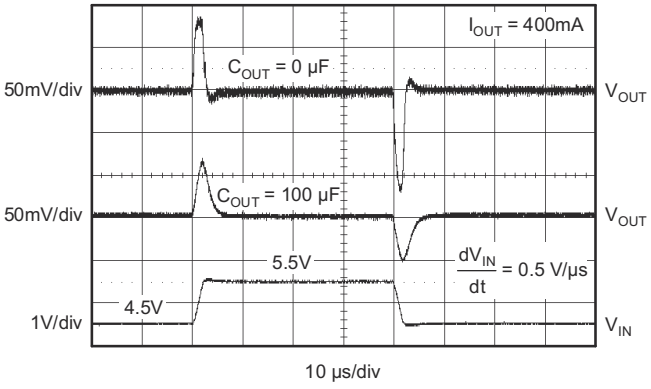
新器件

图 5-36. TPS73633 负载瞬态响应

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

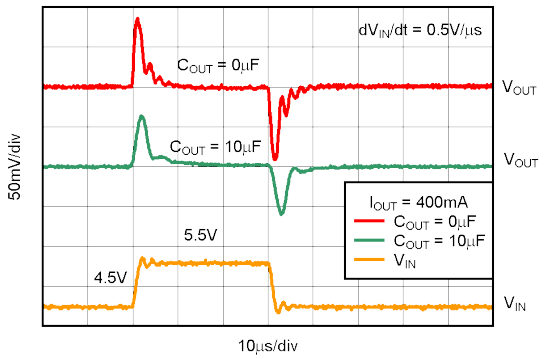
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µ F 条件下（除非另有说明）。



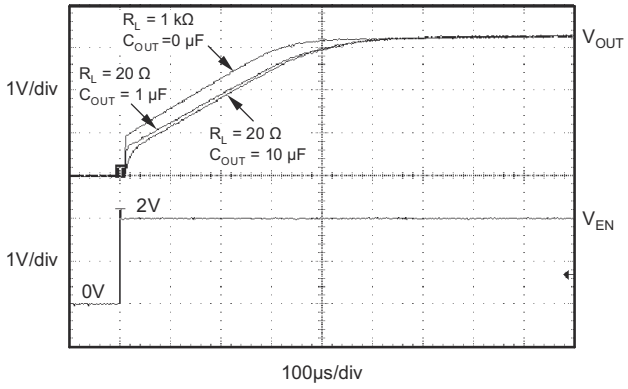
传统器件

图 5-37. TPS73633 线路瞬态响应



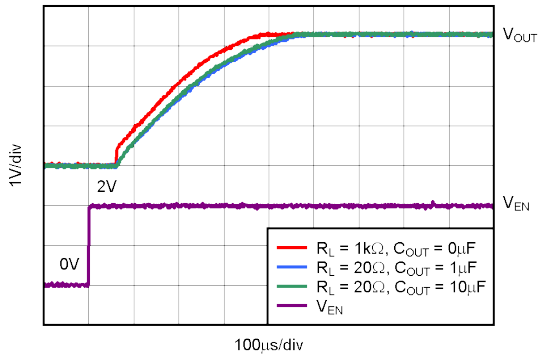
新器件

图 5-38. TPS73633 线路瞬态响应



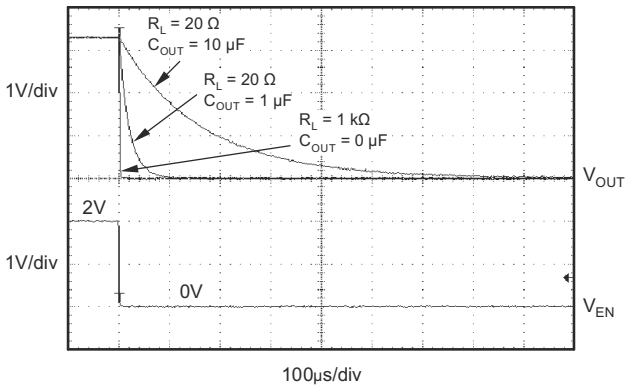
传统器件

图 5-39. TPS73633 导通响应



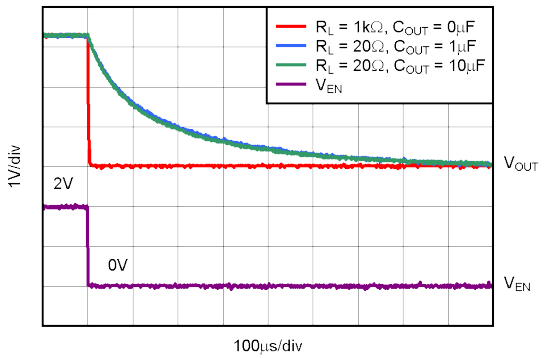
新器件

图 5-40. TPS73633 导通响应



传统器件

图 5-41. TPS73633 关断响应



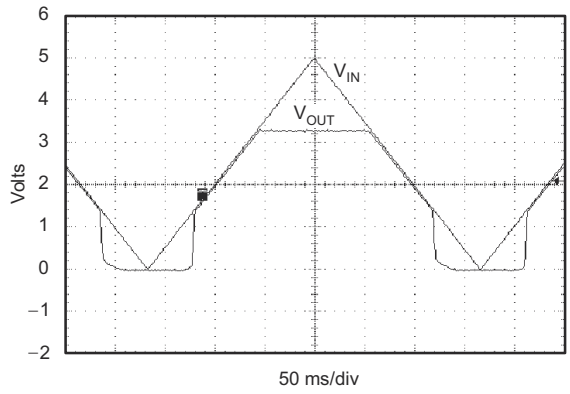
新器件

图 5-42. TPS73633 关断响应

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

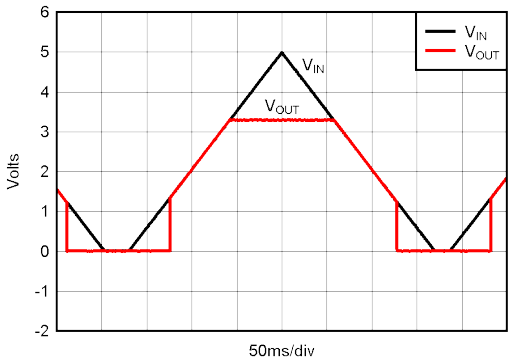
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µF 条件下（除非另有说明）。



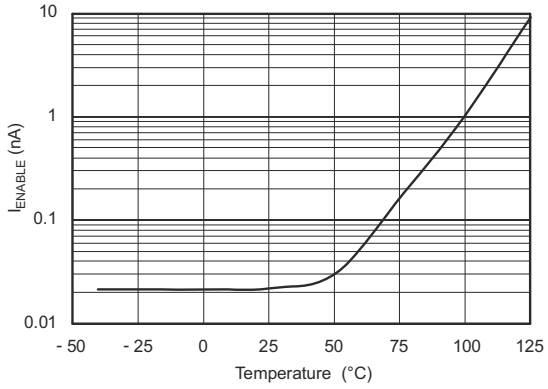
传统器件

图 5-43. TPS73633 上电和断电



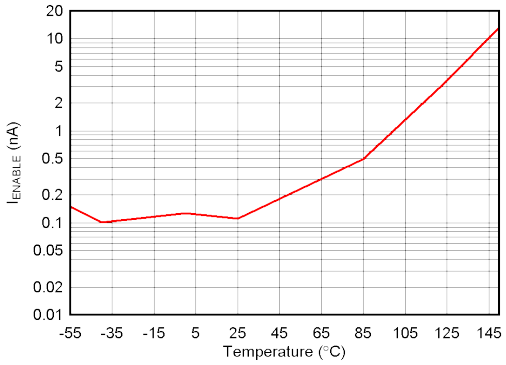
新器件

图 5-44. TPS73633 上电和断电



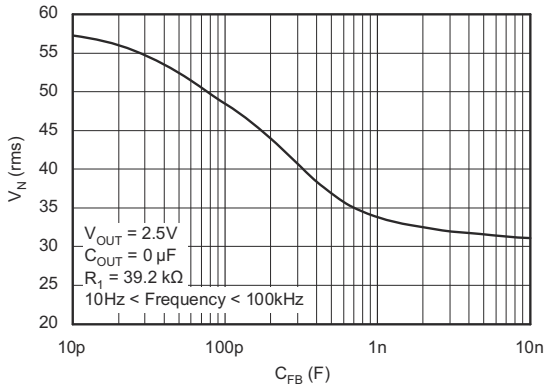
传统器件

图 5-45. I_{ENABLE} 与温度间的关系



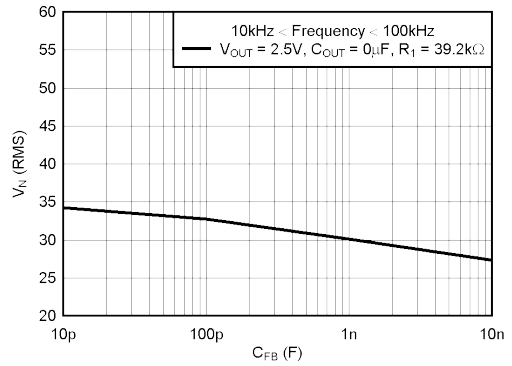
新器件

图 5-46. I_{ENABLE} 与温度间的关系



传统器件

图 5-47. TPS73601 RMS 噪声电压与 C_{FB} 间的关系



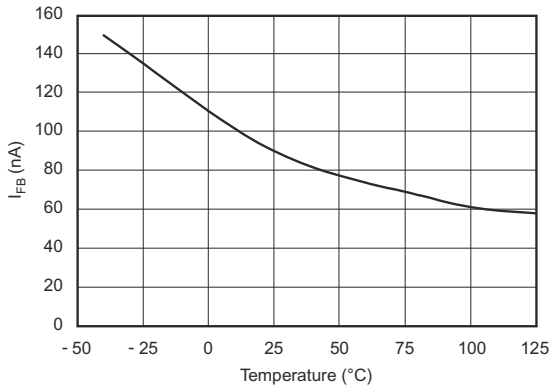
新器件

图 5-48. TPS73601 RMS 噪声电压与 C_{FB} 间的关系

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

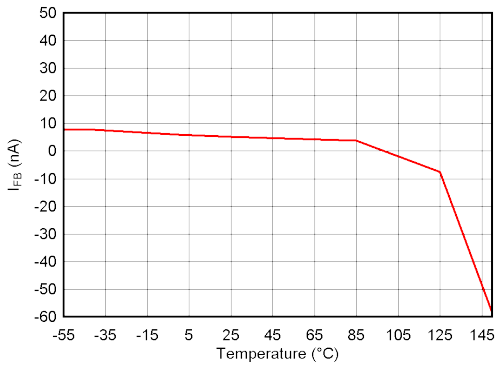
5.7 典型特性（续）

适用于所有电压版本，在 T_J = 25°C、V_{IN} = $V_{OUT(nom)}$ + 0.5V、I_{OUT} = 10mA、V_{EN} = 1.7V 且 C_{OUT} = 0.1 µ F 条件下（除非另有说明）。



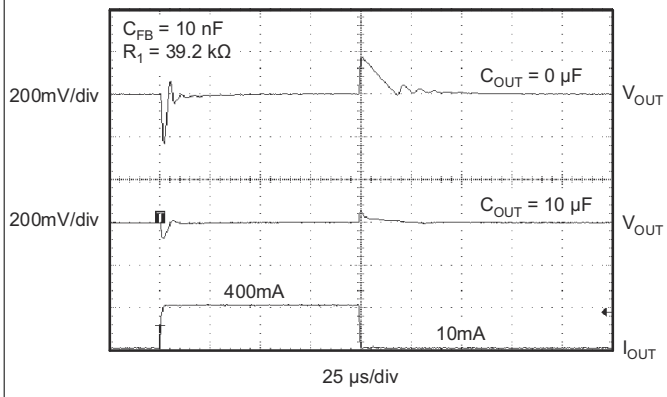
传统器件

图 5-49. TPS73601 I_{FB} 与温度间的关系



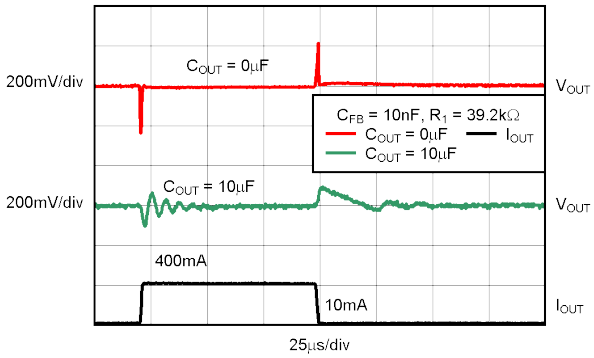
新器件

图 5-50. TPS73601 I_{FB} 与温度间的关系



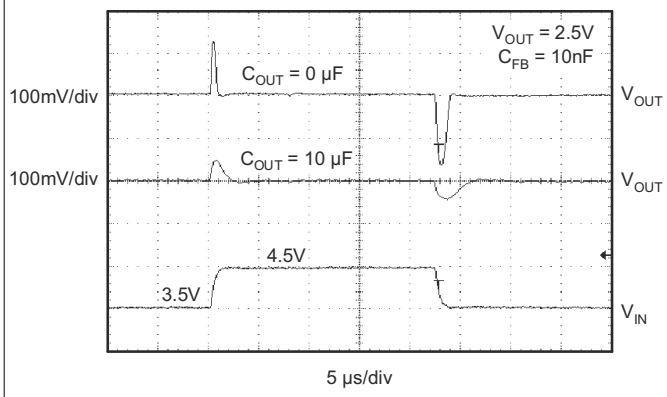
传统器件

图 5-51. TPS73601 负载瞬态，可调节版本



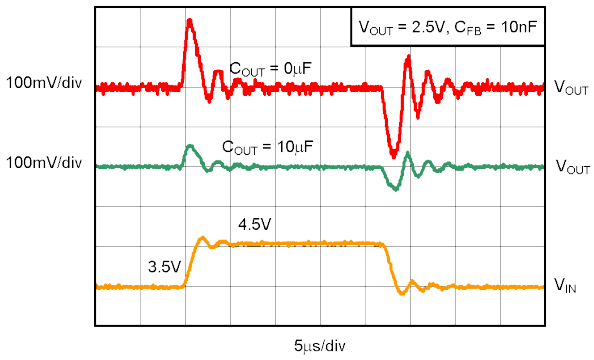
新器件

图 5-52. TPS73601 负载瞬态，可调节版本



传统器件

图 5-53. TPS73601 线路瞬态，可调节版本



新器件

图 5-54. TPS73601 线路瞬态，可调节版本

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

6 详细说明

6.1 概述

TPS736 低压降线性稳压器可在低至 1.7V 的输入电压下工作，并支持低至 1.2V 的输出电压，同时提供高达 400mA 的负载电流。此线性稳压器使用具有集成 4MHz 电荷泵的 NMOS 导通晶体管，以在满负载电流下提供小于 200mV 的压降电压。这种独特的架构还允许在各种输出电容器下实现稳定的调节。实际上，TPS736 器件不需要任何输出电容器即可稳定运行。该线性稳压器对输出电容值和类型的敏感度降低， 因此非常适合 为有效电容未知的负载供电。

TPS736 还具有降噪 (NR) 引脚，可进一步降低输出噪声。借助从 NR 引脚连接至 GND 的 0.01μF 降噪电容器，TPS73615 的典型输出噪声可以低至 12.75μV_{RMS}。TPS736 器件具有低噪声输出，非常适合为 VCO 或任何其他噪声敏感型负载供电。

6.2 功能方框图

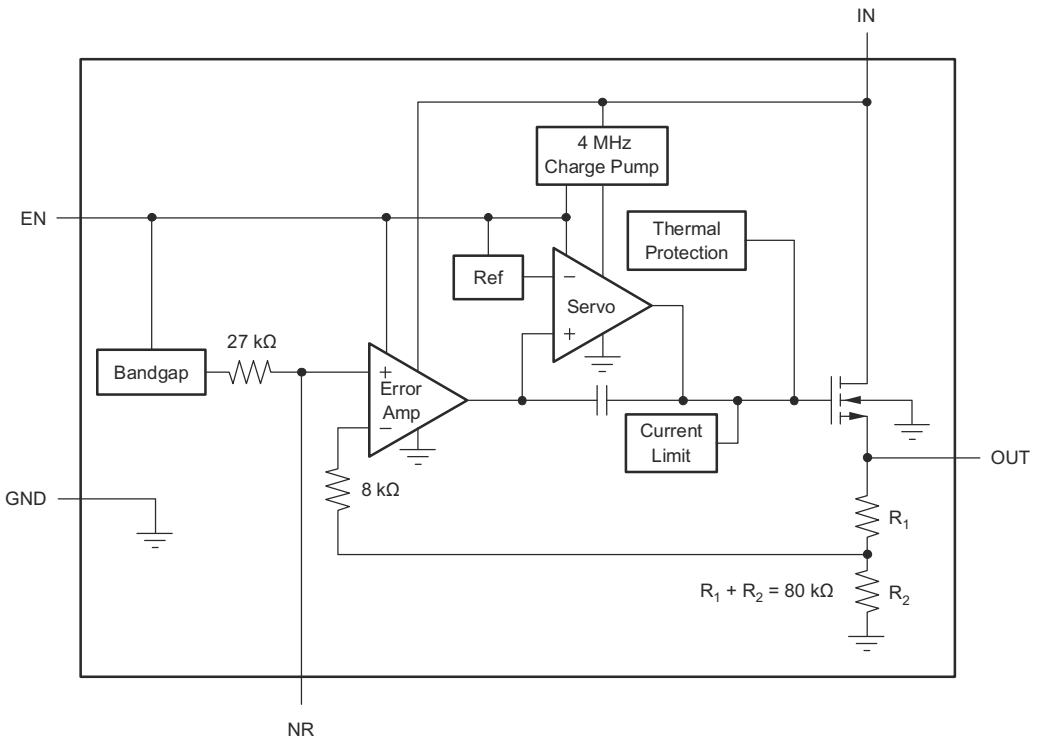
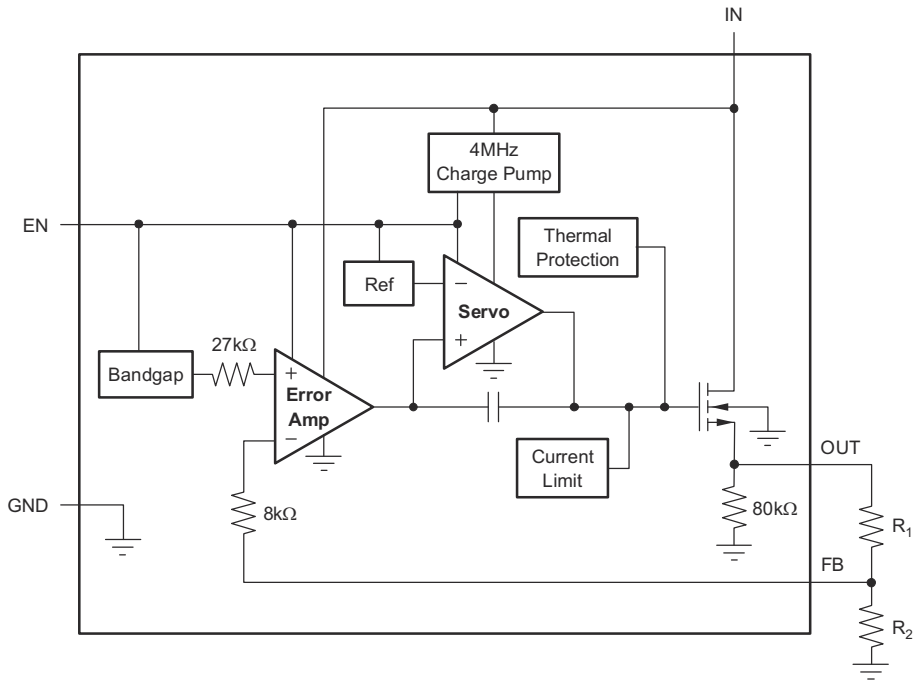


图 6-1. 固定电压版本

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated



Standard 1% Resistor Values for Common Output Voltages

V_O	R_1	R_2
1.2V	Short	Open
1.5V	23.2kΩ	95.3kΩ
1.8V	28.0kΩ	56.2kΩ
2.5V	39.2kΩ	36.5kΩ
2.8V	44.2kΩ	33.2kΩ
3.0V	46.4kΩ	30.9kΩ
3.3V	52.3kΩ	30.1kΩ

NOTE: $V_{OUT} = (R_1 + R_2)/R_2 \times 1.204$; $R_1 || R_2 \cong 19k\Omega$ for best accuracy.

图 6-2. 可调电压版本

6.3 特性说明

6.3.1 输出噪声

一个精准带隙基准用于生成内部基准电压 V_{REF}。这个基准是 TPS736 内的主要噪声源并且在基准输出 (NR) 上产生大约 32 μV_{RMS}（10Hz 至 100kHz）。稳压器控制环路对基准噪声的增益补偿与对基准电压的增益补偿一致，这样稳压器的噪声电压可大约确定为：

$$V_N = 32\mu V_{RMS} \times \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} = 32\mu V_{RMS} \times \frac{V_{OUT}}{V_{REF}} \quad (1)$$

由于 V_{REF} 的值为 1.2V，这一相互关系减少至：

$$V_N(\mu V_{RMS}) = 27\left(\frac{\mu V_{RMS}}{V}\right) \times V_{OUT}(V) \quad (2)$$

（对于没有 C_{NR} 的情况）。

当一个外部降噪电容器 C_{NR} 被从 NR 接至接地时，一个与降噪引脚 (NR) 串联的内部 27kΩ 电阻器为电压基准形成一个低导通滤波器。因为 C_{NR} = 10nF，根据给出的大致关系，10Hz 至 100kHz 带宽内的总噪声被减少了大约 3.2 倍：

$$V_N(\mu V_{RMS}) = 8.5\left(\frac{\mu V_{RMS}}{V}\right) \times V_{OUT}(V) \quad (3)$$

C_{NR} = 10nF。

该降噪效应显示在 *典型特性* 部分的 ***RMS** 噪声电压与 C_{NR} 间的关系*图中。

TPS73601 可调版本没有可用的 NR 引脚。不过，将一个反馈电容器 C_{FB} 从输出连接至反馈引脚 (FB) 将降低输出噪声并提升负载瞬态性能。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

TPS736 使用一个内部电荷泵来形成内部电源电压，此电压足以将 NMOS 导通晶体管元件的栅极驱动至高于 V_{OUT} 的水平。此电荷泵在大约 4MHz 时生成大约 250 μV 的开关噪声；然而，对于大多数 I_{OUT} 和 C_{OUT} 的值，电荷泵噪声对于稳压器输出的影响可以忽略不计。

6.3.2 内部电流限制

TPS736 内部电流限制有助于在故障情况下对稳压器进行保护。当 V_{OUT} 降到低于 0.5V 时，折返电流限制有助于通过降低电流限制，在输出短路情况下保护稳压器免受损坏。请参阅*典型特性*部分中的图 5-17。

请注意，来自 图 5-17 的大约 –0.2V 的 V_{OUT} 会导致 0mA 的电流限制。因此，如果在 EN 变为高电平前，强制使 OUT 电压低于 –0.2V，器件可能无法启动。在使用一个正电源和负电源的应用中，TPS736 必须首先启用。

6.3.3 使能引脚和关断

使能引脚 (EN) 高电平有效并且与标准 TTL-CMOS 电平兼容。V_{EN} 低于 0.5V（最大值）会关闭稳压器并将 GND 引脚的电流降至大约 10nA。当 EN 用来关闭稳压器时，导通晶体管的栅极电荷会被完全清除。V_{EN} 高于 1.7V（最小值）会打开稳压器，并且输出会斜升至稳定的 V_{OUT}（请参阅 图 5-40）。

不需要关断功能时，请将 EN 连接到 V_{IN}。然而，使用此配置时，导通晶体管无法放电，并且导通晶体管也有可能在 V_{IN} 被移除之后相当长的一段时间内保持导通（增强）状态。这个情况会导致反向电流（如果 IN 引脚为低阻抗）并在加电时产生更快的斜坡时间。此外，对于 V_{IN} 斜坡时间长于几毫秒的情况，输出可能在加电时过冲。

电流限制折返能够防止某些条件下的器件启动。更多信息请参阅*内部电流限制*部分。

6.3.4 反向电流

TPS736 的 NMOS 导通晶体管在其栅极被拉至低电平时，其固有特性可防止电流从稳压器输出端流向输入端。为了 确保 导通晶体管栅极上的所有电荷被移除，在移除输入电压前，EN 引脚必须被驱动至低电平。若未执行此操作，栅极存储的电荷可能导致导通晶体管保持导通状态。

在 EN 引脚被驱动至低电平时，在任一引脚上无需偏置电压即可实现反向电路阻断。反向电流定义为由于施加到 OUT 引脚上的电压而从 IN 引脚中流出的电流。由于 80kΩ 内部电阻分压器接地，将有额外的电流流入 OUT 引脚（请见 图 6-1 和 图 6-2）。

对于 TPS73601，当 V_{FB} 高于 V_{IN} 超过 1.0V 时，可能产生反向电流。

6.4 器件功能模式

6.4.1 正常运行，1.7V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V 且 V_{EN} ≥ 1.7V

TPS736 需要至少为 1.7V 的输入电压，才能正常运行并尝试保持稳压。如果输入电压为 1.7V 时器件输出电压大于 1.5V，器件会在压降状态下运行，无法保持稳压。由于 TPS736 中使用的 NMOS 架构，压降电压不是输入电压的强函数。

当器件在接近 5.5V 的电压下运行时，应注意抑制任何可能超过 6.0V 绝对最大额定电压的瞬态尖峰。该器件绝不能在大于 5.5V 的直流电压下运行。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

7.1 应用信息

TPS736 是一款 LDO 稳压器，其使用一个 NMOS 导通晶体管来实现超低压降性能、反向电流阻断，以及不受输出电容器的限制。这些特性与低噪声和一个使能输入相结合，使得 TPS736 非常适合便携式应用。该稳压器提供多种固定输出电压版本和一个可调输出版本。所有版本都具有过热以及过流保护，其中包括折返电流限制。

7.2 典型应用

图 7-1 显示了针对固定电压模型的基本电路连接。图 7-2 提供了可调输出版本 (TPS73601) 的连接。

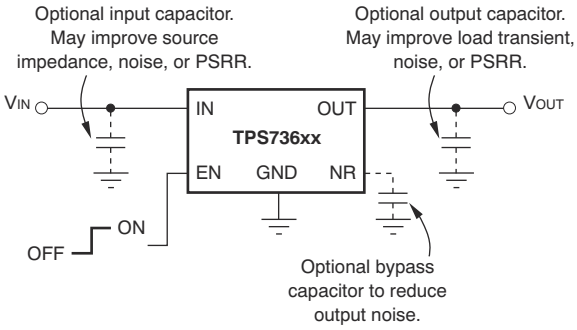


图 7-1. 针对固定电压版本的典型应用电路

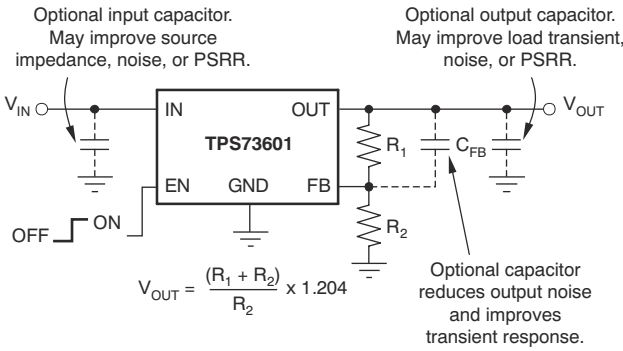


图 7-2. 可调电压版本的典型应用电路

7.2.1 设计要求

本设计示例使用下面列出的参数作为输入参数。

表 7-1. 设计参数（固定电压版本）

参数	设计要求
输入电压	5V，±3%
输出电压	3.3V，±1%
输出电流	400mA（最大值）、20mA（最小值）
RMS 噪声，10Hz 至 100kHz	< 30 μ V_{RMS}
环境温度	55°C（最大值）

表 7-2. 设计参数（可调电压版本）

参数	设计要求
输入电压	5V，±3%，由开关频率为 1MHz 的 DC/DC 转换器提供
输出电压	2.5V，±1%
输出电流	0.4A（最大值）、10mA（最小值）
RMS 噪声，10Hz 至 100kHz	< 35 μ V_{RMS}
环境温度	55°C（最大值）

7.2.2 详细设计过程

使用线性稳压器进行设计时，第一步是检查最大负载电流以及输入和输出电压要求，以确定是否可以满足器件的散热要求和压降电压要求。在 0.4A 电流下，TPS73633 在整个温度范围内的最大压降为 200mV；因此，压降余量足以确保器件在输入和输出电压精度下运行。

线性稳压器中耗散的最大功率为导通晶体管上从输入到输出的最大压降与最大负载电流的乘积。在本例中，导通晶体管上的最大压降为 5V + 3% (5.15V) 减去 3.3V – 1% (3.267V) 或 1.883V。可以通过将此压降乘以最大负载电流来计算导通晶体管中耗散的功率。对于本示例，线性稳压器中的最大耗散功率为 942mW。一旦知道线性稳压器中的功率耗散，就可以计算出相应的结温上升。要计算结温相对于环境的上升，必须将功耗乘以结到环境的热阻。有关热阻的信息，请参阅 *热保护* 部分。对于此示例，使用 DRB 封装，计算出的最大结温上升为 45°C。最大结温上升的计算方式是，将结温上升与最高环境温度相加。在此示例中，最高结温为 100°C。请记住，最高结温必须低于 125°C 才能实现可靠运行。增加接地平面，增加散热孔和气流都有助于降低最高结温。不建议在此应用中使用 DCQ 或 DBV 封装，因为产生的结温上升过高。

为了获得低于 30μV_{RMS} 的噪声水平，选择了 10nF 的降噪电容 (C_{NR}) 以及 10 μ F 的输出电容。参考 *输出噪声* 部分，可以计算出 RMS 噪声为 28μV_{RMS}。

使用输入电容器是可选的。但是，在输入电源距离 LDO 只有几英寸的系统中，建议使用小型 0.1μF 输入电容器来消除输入电源电感对稳定性和交流性能的不利影响。

与使用固定输出电压的设计相同，第一步是检查最大负载电流以及输入和输出电压要求，以确定是否满足器件的散热性能和压降电压要求。在 0.4A 的电流下，最大压降电压为 200mV。由于输入电压为 5V、输出电压为 2.5V，因此有足够的电压余量来避免压降并保持良好的 PSRR。

线性稳压器中耗散的最大功率为导通晶体管上从输入到输出的最大压降与最大负载电流的乘积。在本例中，导通晶体管上的最大压降为 5V + 3% (5.15V) 减去 2.5V – 1% (2.475V) 或 2.675V。可以通过将此压降乘以最大负载电流来计算导通晶体管中耗散的功率。对于本示例，线性稳压器中的最大耗散功率为 1.07W。一旦知道线性稳压器中的功率耗散，就可以计算出相应的结温上升。要计算结温相对于环境的上升，必须将功耗乘以结到环境的热阻。有关热阻的信息，请参阅 *热性能信息* 表。对于此示例，使用 DRB 封装，计算出的最大结温上升为 51°C。最大结温上升的计算方式是，将结温上升与最高环境温度相加。在此示例中，最高结温为 106°C。请记住，最高结温必须低于 125°C 才能实现可靠运行。增加接地平面，增加散热孔和气流都有助于降低最高结温。不建议在此应用中使用 DCQ 或 DBV 封装，因为产生的结温上升过高。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

使用图 7-2 中显示的公式，R_1 和 R_2 可用于计算任一输出电压。针对共同输出电压的取样电阻器值显示在图 6-2 中。

对了获得最佳精度，应当使 R_1 和 R_2 的并联组合值约为 19kΩ。除了内部的 8kΩ 电阻器，这个 19kΩ 的电阻值为误差放大器提供了与 27kΩ 带隙基准输出相同的阻抗。这个阻抗有助于补偿进入误差放大器端子的泄漏。

对 2.5V 输出使用 图 6-2 中的值将得出 R_1 为 39.2kΩ，R_2 为 36.5kΩ 的值。

为获得低于 $35\mu V_{RMS}$ 的噪声水平，选择 10nF 的降噪电容 (C_{FF})。在为 C_{FF} 选择最佳值时，必须使用 图 5-47 作为参考。

该设计的输出端采用了 10µF 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷 X5R 电容器，以最大限度减少低瞬态期间的输出压降。使用输入电容器是可选的。但是，在输入电源距离 LDO 只有几英寸的系统中，建议使用小型 0.1µF 输入电容器来消除输入电源电感对稳定性和交流性能的不利影响。有关输入和输出电容器选择的更多信息，请参阅 *输入和输出电容器要求* 部分。

7.2.2.1 输入和输出电容器要求

虽然无需输入电容器即可实现稳定，好的模拟设计实践是将一个 0.1µF 至 1µF 低 ESR 电容器连接到稳压器附近的输入电源上。该电容器抵消了被重新激活的输入源并且提升了瞬态响应、噪声抑制、以及纹波抑制。如果有可能出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离电源几英寸远的话，有可能需要一个更大电容值的电容器。

TPS736 无需输出电容器即可实现稳定运行，并且无需电容器即可实现最大相位裕量。该器件经过专门设计，可在与所有可用类型和电容值的电容器一起工作时保持稳定。在多个低 ESR 电容器并联的应用中，当 C_{OUT} 和总 ESR 的乘积降至 50nΩ × F 以下时，可能会发生振铃。总 ESR 包括所有寄生电阻、包括电容器 ESR 以及和电路板、插座和焊点电阻。在大多数应用中，电容器 ESR 和走线电阻值的总和满足这一要求。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

7.2.2.2 压降电压

TPS736 使用一个 NMOS 导通晶体管来实现极低压降。当 (V_{IN} – V_{OUT}) 低于压降电压 (V_{DO}) 时，NMOS 导通晶体管处于其运行的线性区域并且输入到输出电阻是 NMOS 导通晶体管的 $R_{DS(on)}$。

对于负载电流的较大阶跃变化，TPS736 需要从 V_{IN} 到 V_{OUT} 的更大压降，以避免降低瞬态响应性能。这个瞬变压降区域的边界大约为 dc 输出的两倍。在这个边界之上的 V_{IN} – V_{OUT} 的值提供了正常瞬态响应。

在瞬态压降区域内运行会增加恢复时间。从一个负载瞬态中恢复所需的时间是负载电流速率变化幅度、负载电流的变化速率、和可用动态空间（V_{IN} 至 V_{OUT} 压降）的函数。在最差的情况下（(V_{IN} – V_{OUT}) 的满量程瞬时负载变化接近 DC 压降水平），TPS736 可在几百毫秒内返回特定的调节精度。

7.2.2.3 瞬态响应

在电压跟随器配置中，NMOS 导通晶体管提供的低开环输出阻抗使该器件在许多应用中无需输出电容器即可运行。当与任一稳压器一同工作时，一个从 OUT 引脚到接地间增加的电容器（标称值 1 µF）将减少下冲幅度但是会增加持续时间。在可调版本中，在 OUT 引脚到 FB 引脚间增加的电容器 C_{FB} 也会提升瞬态响应性能。

当输出过压时，TPS736 没有有源下拉功能。该功能使得应用能够将诸如替代电源的更高电压源连接至输出。当一个电容器被连接至输出上时，如果负载电流快速下降至零，该功能也将导致一个几个百分点的输出过冲。通过增加一个负载电阻器可减少过冲的持续时间。过冲衰减速率由输出电容器 C_{OUT} 和内部/外部负载电阻值确定。衰减速率由以下因素确定：

Fixed voltage version

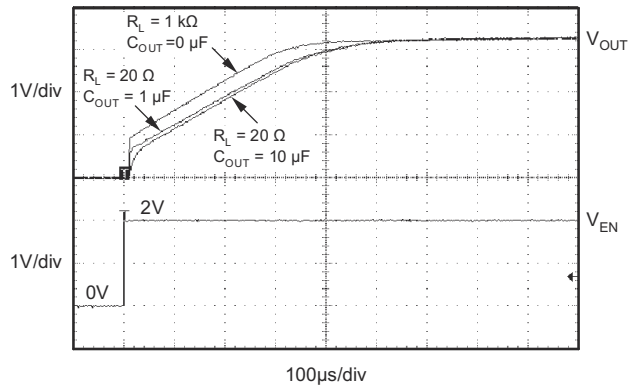
$$dV / dt = \frac{V_{OUT}}{C_{OUT} \times 80\ k\Omega \parallel R_{LOAD}} \quad (4)$$

Adjustable voltage version

$$dV / dt = \frac{V_{OUT}}{C_{OUT} \times 80\ k\Omega \parallel (R_1 + R_2) \parallel R_{LOAD}} \quad (5)$$

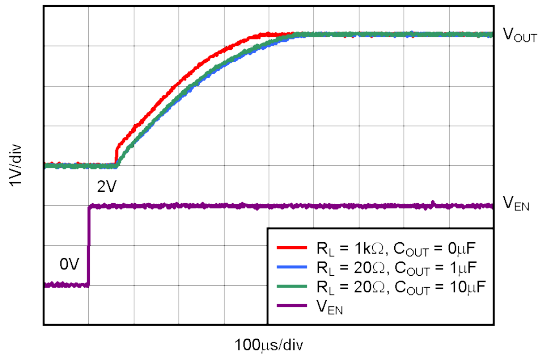
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

7.2.3 应用曲线



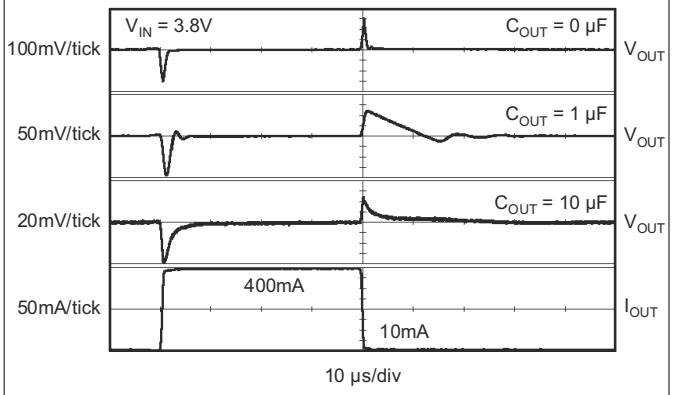
传统器件

图 7-3. TPS73633 导通响应



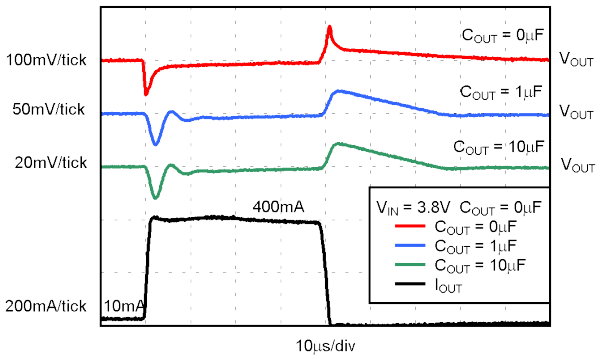
新器件

图 7-4. TPS73633 导通响应



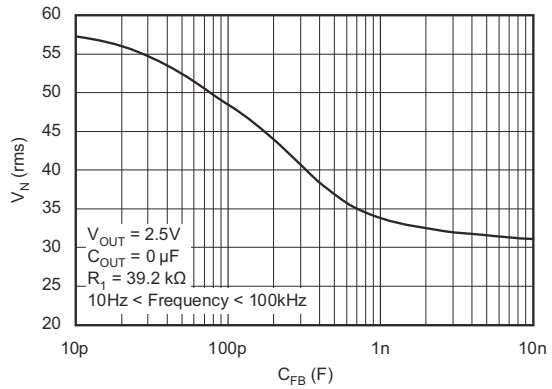
传统器件

图 7-5. TPS73633 负载瞬态响应



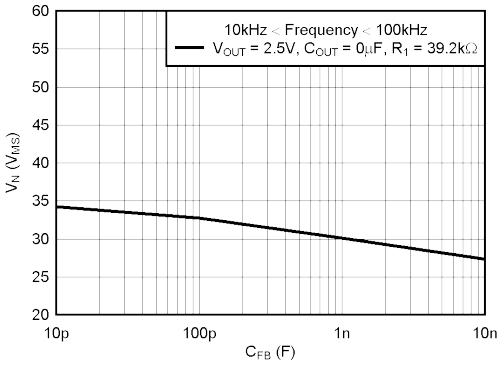
新器件

图 7-6. TPS73633 负载瞬态响应



传统器件

图 7-7. TPS73601 RMS 噪声电压与 C_{FB} 间的关系



新器件

图 7-8. TPS73601 RMS 噪声电压与 C_{FB} 间的关系

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

7.2.3 应用曲线（续）

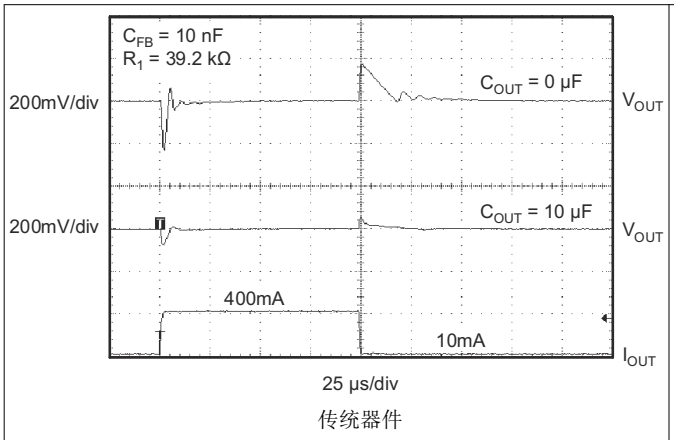


图 7-9. TPS73601 负载瞬态，可调节版本

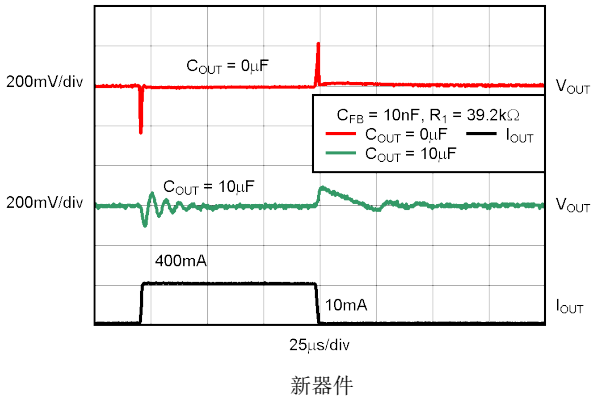


图 7-10. TPS73601 负载瞬态，可调节版本

7.3 电源相关建议

此器件设计为在 1.7V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。如果输入电源存在噪声，则附加具有低 ESR 的输入电容器有助于提高输出噪声性能。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

为了提高交流性能（如 PSRR、输出噪声和瞬态响应等），在设计电路板时应为 V_{IN} 和 V_{OUT} 电容器提供接地平面连接，并将接地平面连接到器件的 GND 引脚。此外，针对旁路电容器的接地连接必须直接接至器件的 GND 引脚。

7.4.1.1 功率耗散

对于每一种封装类型，为芯片散热的能力也不同，这体现在印刷电路板 (PCB) 布局的不同考虑中。器件周围没有其他组件的 PCB 区域会将器件的热量散发到周围空气中。*热性能信息* 表中列出了 JEDEC 低 K 电路板和高 K 电路板的性能数据。使用较重的覆铜可提高器件的散热效率。在散热层上增加的电镀通风孔也能提升散热效率。

功耗取决于输入电压和负载情况。功率耗散 (P_D) 等于输出电流乘以输出导通晶体管（V_{IN} 至 V_{OUT}）上的压降所得到的乘积：

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT} \quad (6)$$

通过使用提供所需输出电压的最低可能输入电压可大大减小功率耗散。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

7.4.1.2 热保护

当结温上升至大约 160°C 时，过热保护会禁用输出以使器件冷却。当结温冷却至大约 140°C 时，输出电路将被重新使能。根据功率耗散、热阻和环境温度的变化，过热保护电路可能会循环开启和关断。这样就限制了稳压器的功率耗散，从而保护器件不受过热损坏。

任何有可能激活过热保护电路的情况表示过多的功率耗散或者不够充分的散热。为了实现可靠运行，结温必须被限制为最高 125°C。为了估算一个完整设计中（包括散热）的安全裕量，增加环境温度直到触发过热保护；使用最差情况负载和信号条件。为了实现更好的稳定性，过热保护应该在比您的应用的最大预计环境温度至少高 35°C 时触发。这样就在最高预计环境温度和最差情况负载上产生了一个 125°C 最差情况结温。

TPS736 内部保护电路的设计可防止出现过载情况。该电路并不是为了取代适当的散热装置。TPS736 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。

7.4.2 布局示例

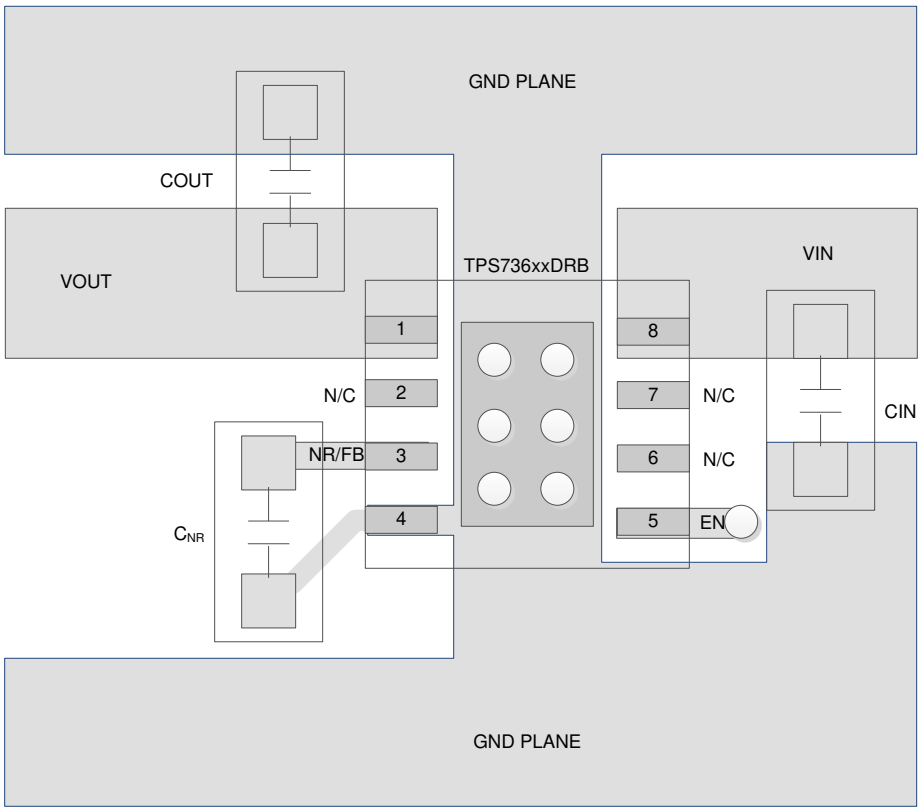


图 7-11. 固定输出电压选项布局（DRB 封装）

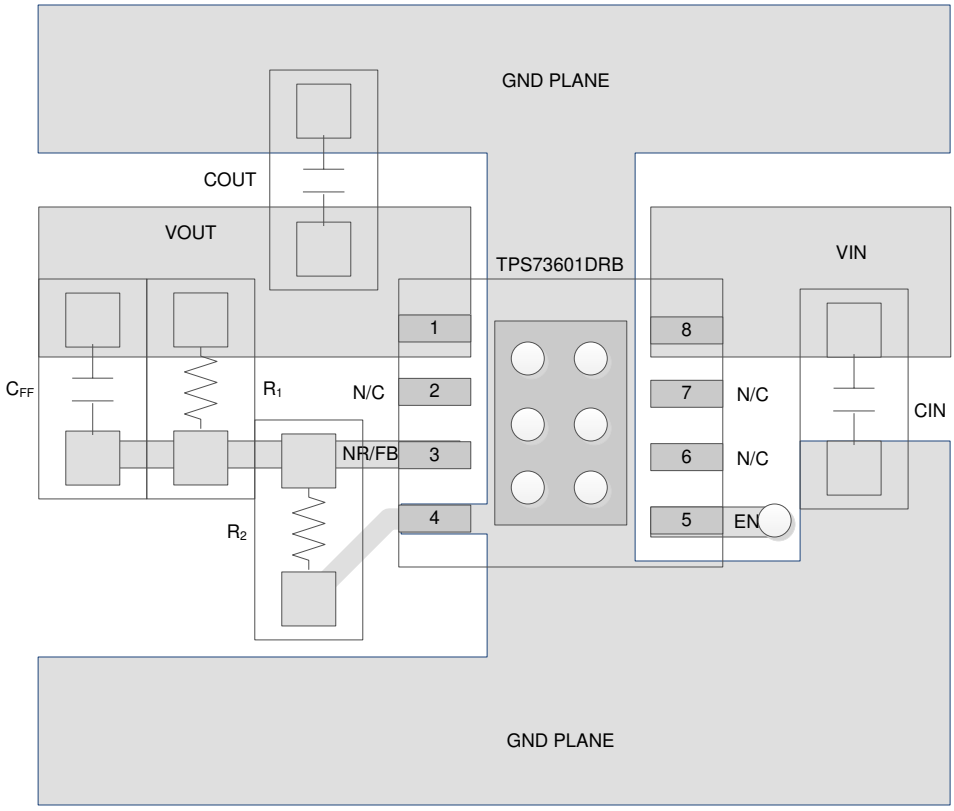


图 7-12. 可调输出电压选项布局（DRB 封装）

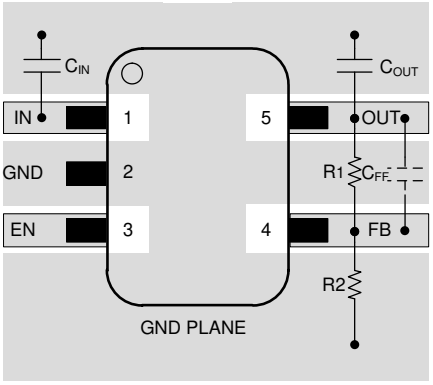


图 7-13. DBV 封装可调节版本的布局示例

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

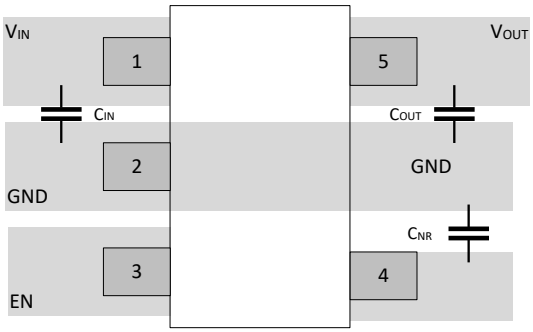


图 7-14. DBV 封装固定版本的布局示例

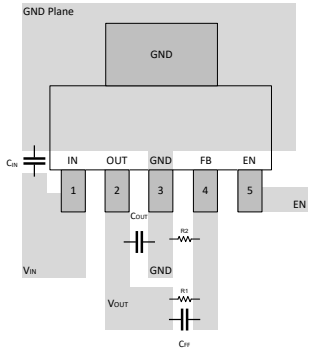


图 7-15. DCQ 封装可调节版本的布局示例

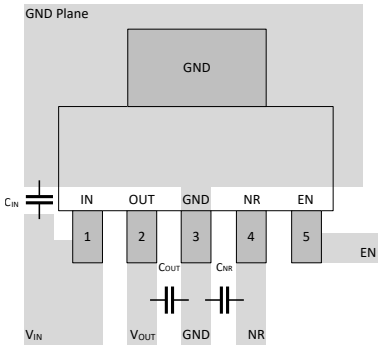


图 7-16. DCQ 封装固定版本的布局示例

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 开发支持

8.1.1.1 评估模块

评估模块 (EVM) 可与 TPS736 配套使用，帮助评估初始电路性能。TPS73601DRBEVM-518 评估模块（以及相关的用户指南）可在德州仪器 (TI) 网站上的产品文件夹中获取，也可直接从 TI 网上商店购买。

8.1.1.2 Spice 模型

分析模拟电路和系统的性能时，使用 SPICE 模型通常有利于对电路性能进行计算机仿真。您可以从产品文件夹中的*仿真模型*下获取 TPS736 的 SPICE 模型。

8.1.2 器件命名规则

表 8-1. 器件命名规则

产品(1)	说明
TPS736**xxyyy z(M3)**	**xx** 为标称输出电压（例如，25 = 2.5V、01 = 可调节）。 **yyy** 为封装指示符。 **z** 为封装数量。 **M3** 是仅使用最新制造流程的器件的后缀指示符（CSO：RFB）。没有这个后缀的器件可随附*传统器件*（CSO：DLN）或*新器件*（CSO：RFB）。卷带封装标签提供 CSO 信息以区分正在使用的器件。全篇对新器件和传统器件的器件性能进行了说明。

(1) 有关最新的封装和订购信息，请参阅本文档结尾的封装选项附录，或访问 TI 网站 www.ti.com。

8.2 文档支持

8.2.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI)、*使用外部基准将 V_{OUT} 调节至 1.2V 以下*应用手册
- 德州仪器 (TI)，*TPS73x01DRBEVM-518* 用户指南

8.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知*进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.4 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

8.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

8.6 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

8.7 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision W (May 2025) to Revision X (May 2025)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	1
• 添加了新器件接地引脚电流规格	6

Changes from Revision V (September 2024) to Revision W (May 2025)	Page
• 更新了 DRB0008A 封装外形图的 DRB (VSON)	4
• 添加了新的硅基 DBV 热性能信息	4
• 在 *使能引脚和关断* 部分，更改了对 EN 的讨论，并添加了有关 EN 打开稳压器的信息	18
• 删除了*封装安装* 部分	25
• 将 *器件命名规则* 表中的 *旧芯片* 更改为 *旧硅片*	28

Changes from Revision U (January 2015) to Revision V (September 2024)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	1
• 向文档中添加了 M3 器件并添加了 M3 新器件*热性能信息* 表	1
• 更改了最大输出电流	4
• 更改了 VFB 典型值	6
• 添加了新器件电流限值	6
• 向 *典型特性* 部分添加了新器件图	7
• 将 *设计参数（固定电压版本）* 表中的 *输出电流* 值从 *500mA* 更改为 *400mA*	20
• 更新了 *详细设计过程* 部分：将压降电压值从 *0.5A* 更改为 *0.4A*，将最大压降电压从估算值更改为 *200mV*	20
• 向*应用曲线*部分添加了新硅片图表	23
• 向 *布局示例* 部分添加了 *DBV 封装可调版本的布局示例* 和 *DCQ 封装固定版本的布局示例* 图	25
• 向 *器件命名规则* 部分添加了 M3 信息	28

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS73601DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVR1G4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVR1G4.A	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVRM3	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVT	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DCQ	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73601
TPS73601DCQG4	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73601
TPS73601DCQR	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73601
TPS73601DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73601
TPS73601DRBR	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBR.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBRG4	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBRM3	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBRM3.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBT	Active	Production	SON (DRB) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBT.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBTG4	Active	Production	SON (DRB) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS736125DRBR	NRND	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T49
TPS736125DRBR.A	NRND	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T49
TPS73615DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T44
TPS73615DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T44
TPS73615DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	T44
TPS73615DCQ	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73615
TPS73615DCQR	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615
TPS73615DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS73615DCQRG4	NRND	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615
TPS73615DCQRG4.A	NRND	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615
TPS73615DRBR	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T44
TPS73615DRBR.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T44
TPS73616DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	OCQ
TPS73616DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	OCQ
TPS73616DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	OCQ
TPS73618DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVRM3	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVT	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DCQR	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73618
TPS73618DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73618
TPS73619DRBR	NRND	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	BYY
TPS73619DRBR.A	NRND	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	BYY
TPS73619DRBT	Obsolete	Production	SON (DRB) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	BYY
TPS73625DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVRG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVRG4.A	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVRM3	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVT	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DCQ	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73625

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS73625DCQR	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73625
TPS73625DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73625
TPS73630DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVRM3	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV) | 5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	T45
TPS73630DCQ	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73630
TPS73630DCQR	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73630
TPS73630DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73630
TPS73632DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
TPS73632DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
TPS73632DBVRG4	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
TPS73632DBVRG4.A	NRND	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
TPS73633DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVR1G4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVR1G4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVRM3	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVT	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DCQ	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73633
TPS73633DCQR	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73633
TPS73633DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ) | 6	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73633
TPS73633DRBR	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T46
TPS73633DRBR.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T46
TPS73633DRBRM3	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DRBRM3.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS73633DRBT	Active	Production	SON (DRB) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DRBT.A	Active	Production	SON (DRB) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DRBTG4	Active	Production	SON (DRB) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73643DBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T54
TPS73643DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T54
TPS73643DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T54

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS736 :

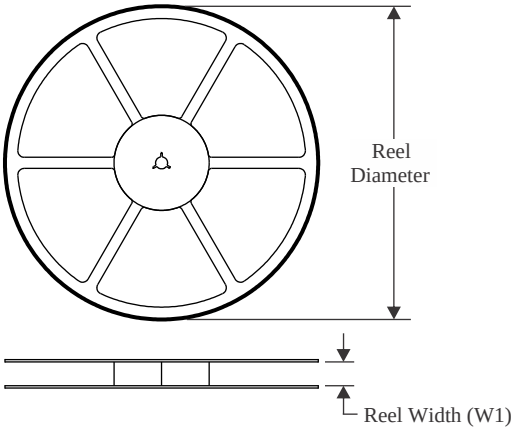
- Automotive : TPS736-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

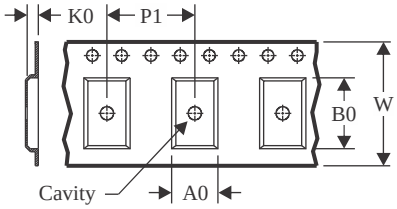
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

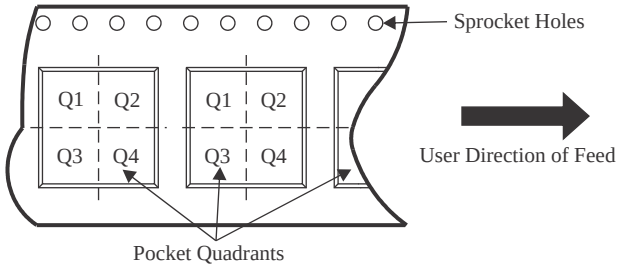


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

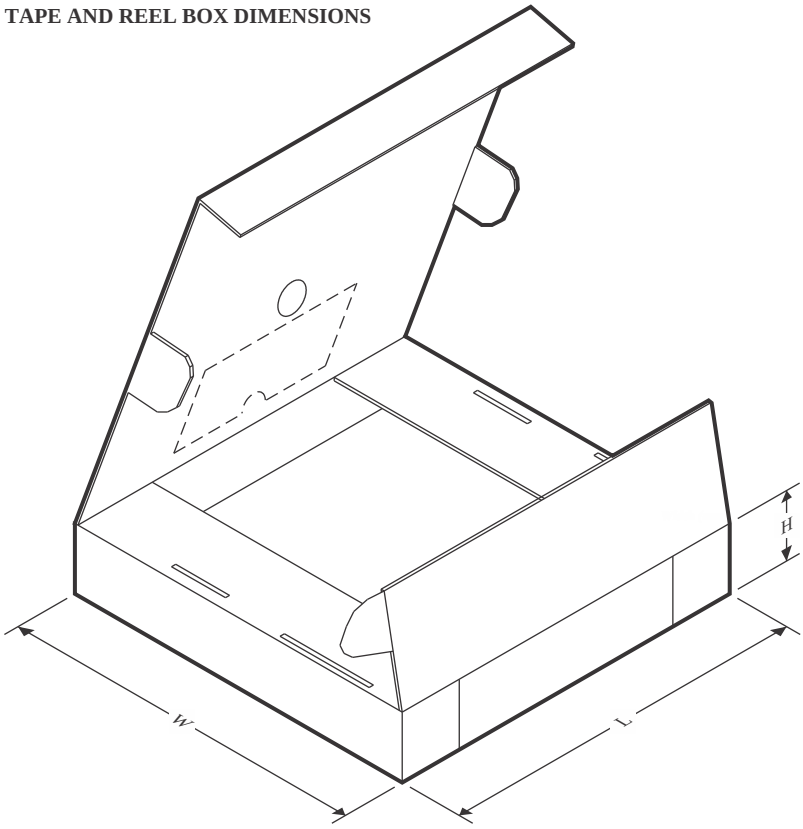


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS73601DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.05	7.4	1.9	8.0	12.0	Q3
TPS73601DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73601DRBRM3	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73601DRBT	SON	DRB	8	250	180.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS736125DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73615DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73615DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	6.85	7.3	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73615DCQRG4	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.1	7.45	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73615DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS73616DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73618DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.05	7.4	1.9	8.0	12.0	Q3
TPS73619DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.0	8.0	12.0	Q2
TPS73625DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	6.85	7.3	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73630DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73630DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73630DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73630DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.1	7.45	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73632DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73632DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.05	7.4	1.9	8.0	12.0	Q3
TPS73633DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73633DRBRM3	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73633DRBT	SON	DRB	8	250	180.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73643DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS73601DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73601DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73601DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	203.0	203.0	35.0
TPS73601DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73601DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73601DBVT	SOT-23	DBV	5	250	210.0	185.0	35.0
TPS73601DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73601DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	366.0	364.0	50.0
TPS73601DRBR	SON	DRB	8	3000	360.0	360.0	36.0
TPS73601DRBRM3	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	35.0
TPS73601DRBT	SON	DRB	8	250	210.0	185.0	35.0
TPS736125DRBR	SON	DRB	8	3000	353.0	353.0	32.0
TPS73615DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73615DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	356.0	356.0	36.0
TPS73615DCQRG4	SOT-223	DCQ	6	2500	346.0	346.0	29.0
TPS73615DRBR	SON	DRB	8	3000	353.0	353.0	32.0
TPS73616DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS73618DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0

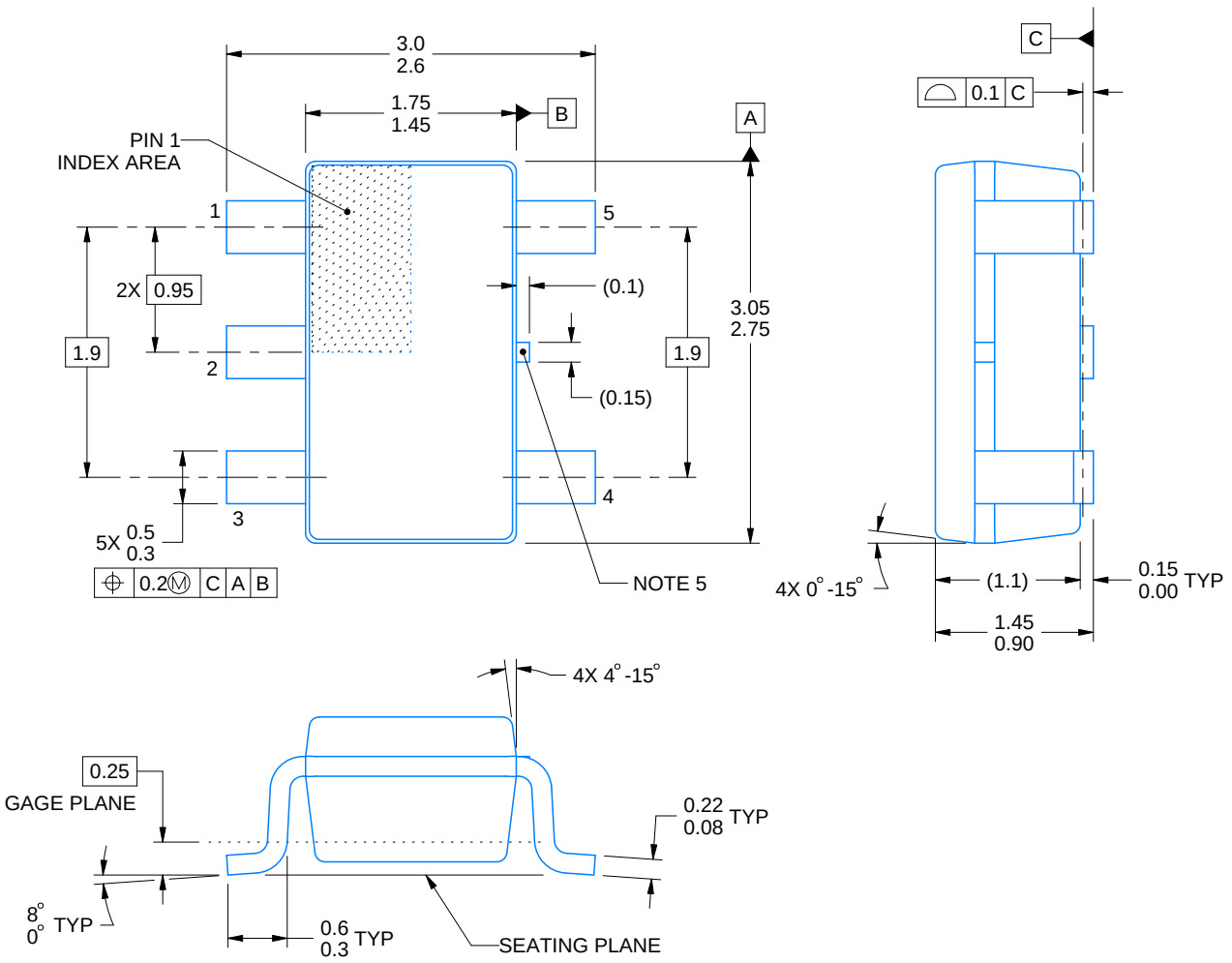
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS73618DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73618DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73618DBVT	SOT-23	DBV	5	250	210.0	185.0	35.0
TPS73618DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73618DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	366.0	364.0	50.0
TPS73619DRBR	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	38.0
TPS73625DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS73625DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73625DBVT	SOT-23	DBV	5	250	210.0	185.0	35.0
TPS73625DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73625DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73625DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	356.0	356.0	36.0
TPS73630DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73630DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73630DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73630DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	346.0	346.0	41.0
TPS73632DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73632DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73633DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73633DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVT	SOT-23	DBV	5	250	210.0	185.0	35.0
TPS73633DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73633DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	366.0	364.0	50.0
TPS73633DRBR	SON	DRB	8	3000	360.0	360.0	36.0
TPS73633DRBRM3	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	35.0
TPS73633DRBT	SON	DRB	8	250	210.0	185.0	35.0
TPS73643DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0

PACKAGE OUTLINE

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

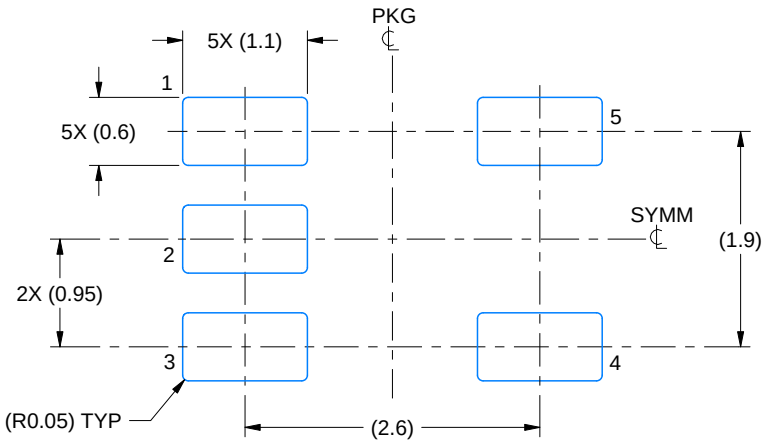
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



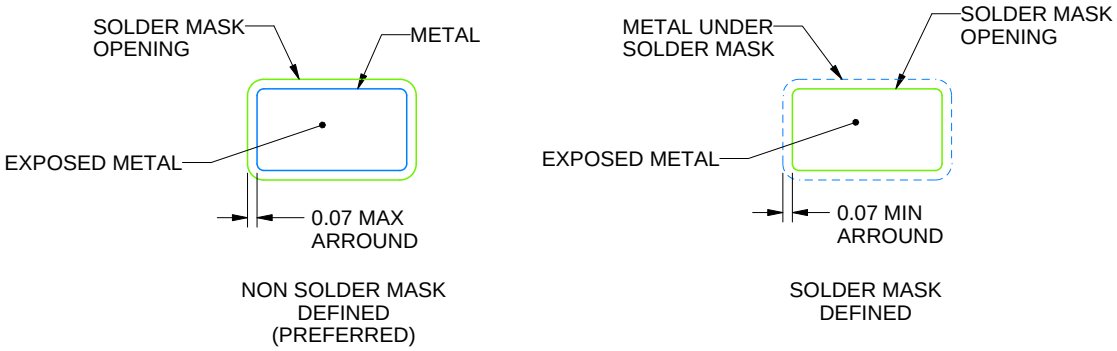
4214839/K 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

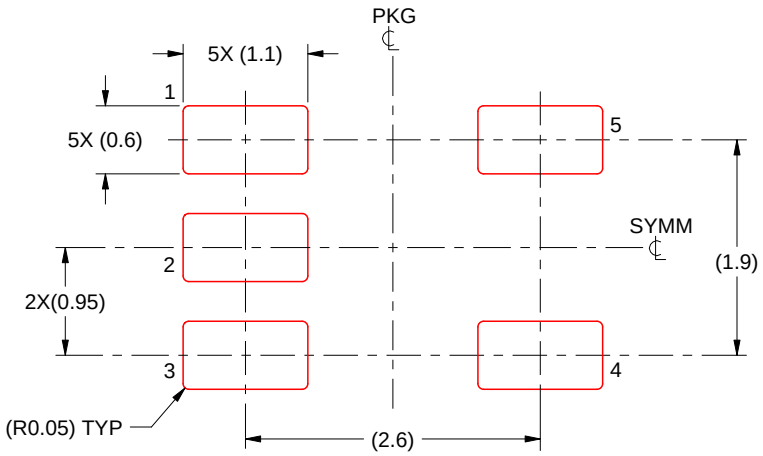


SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

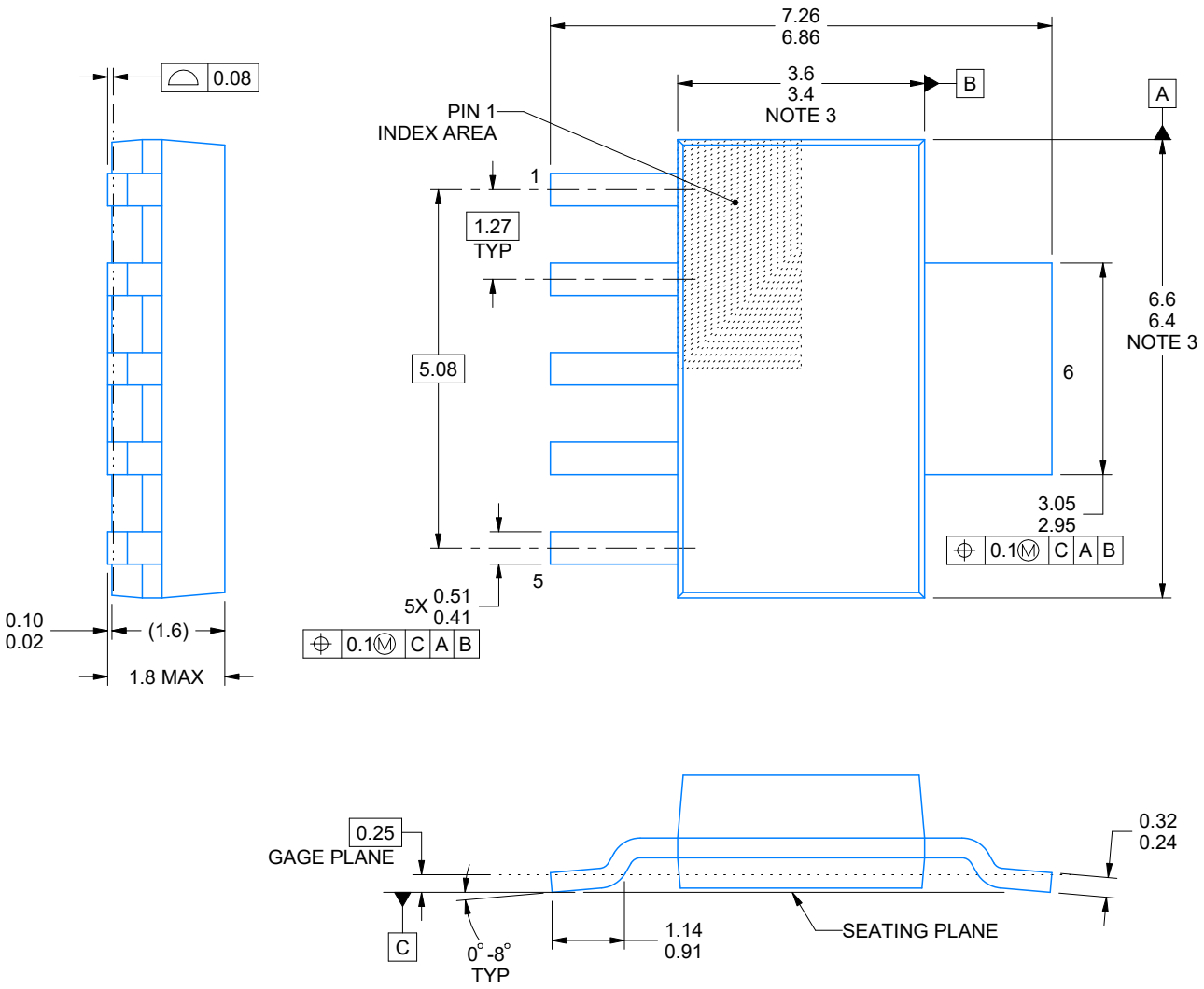
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DCQ0006A

SOT - 1.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



4214845/C 11/2021

NOTES:

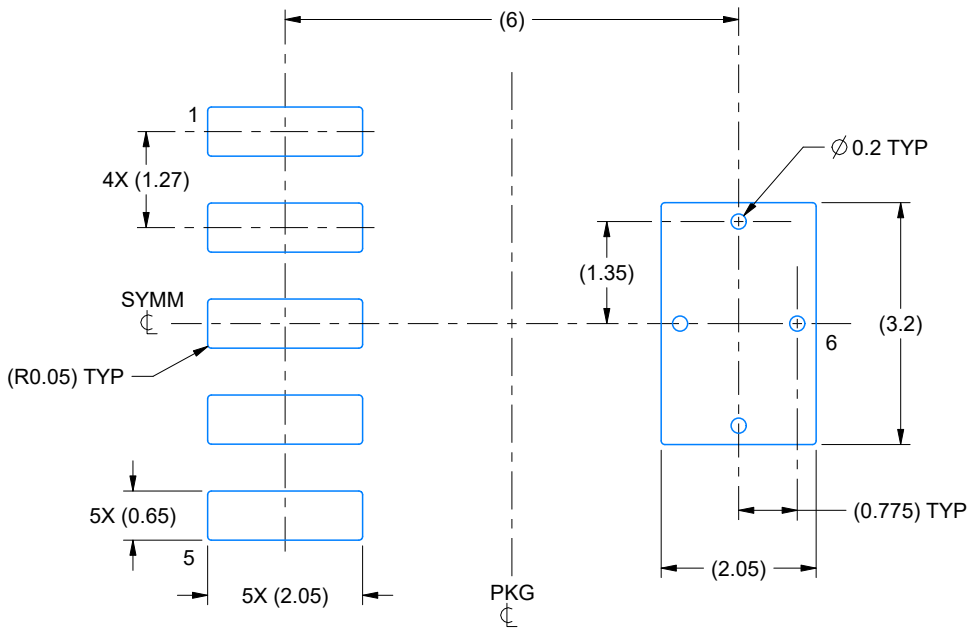
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

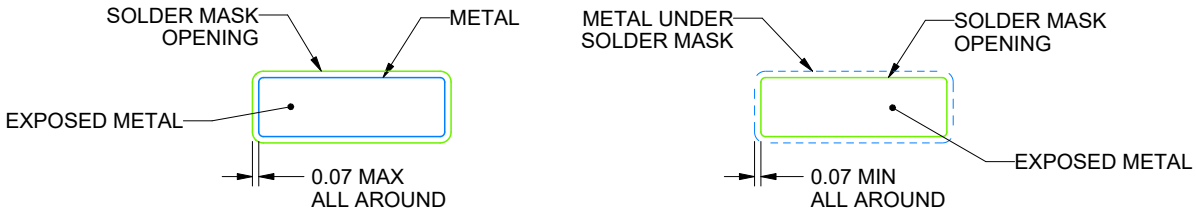
DCQ0006A

SOT - 1.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

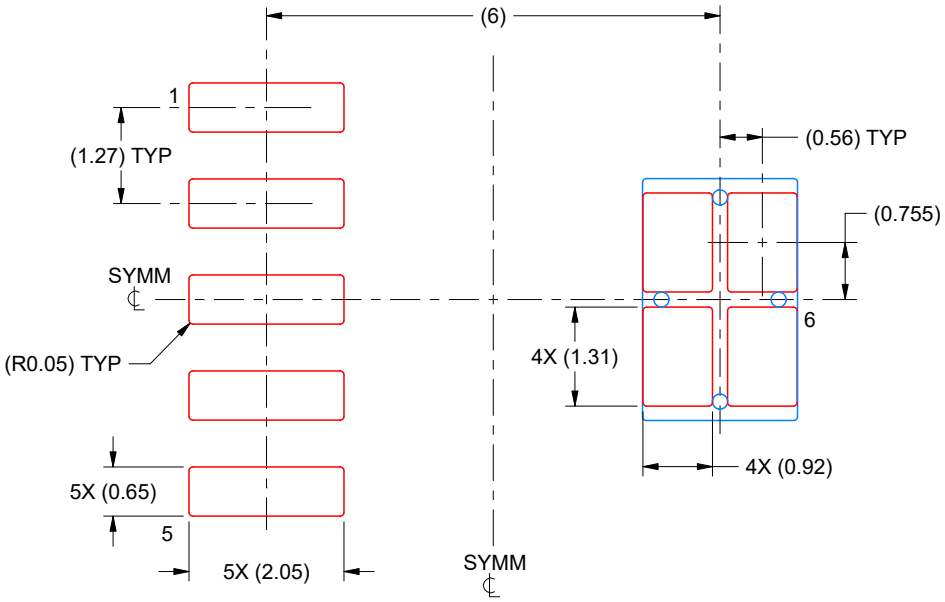


SOLDER MASK DETAILS

4214845/C 11/2021

NOTES: (continued)

4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
6. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4214845/C 11/2021

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

DRB 8 VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

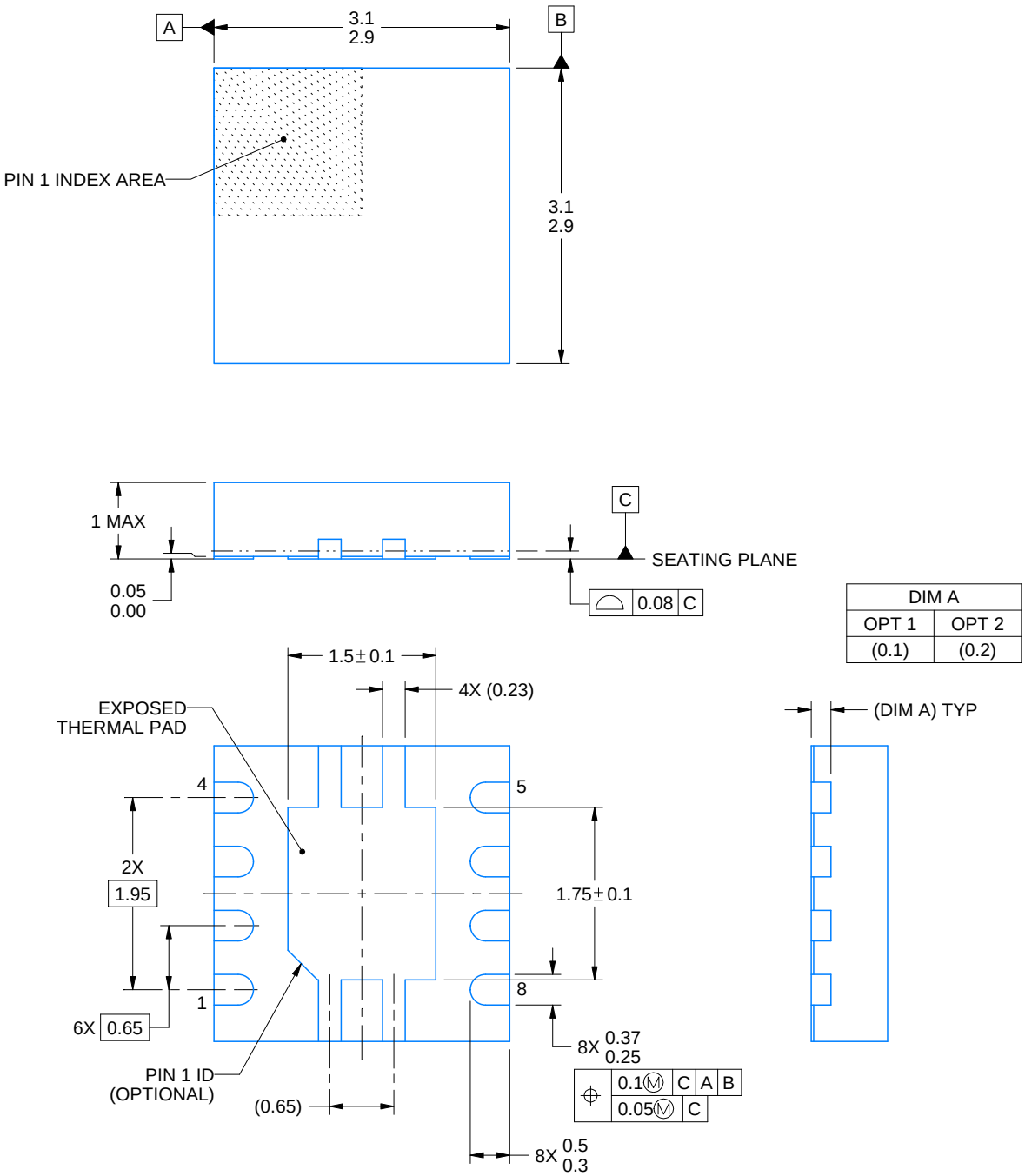
Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

DRB0008A

PACKAGE OUTLINE

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



NOTES:

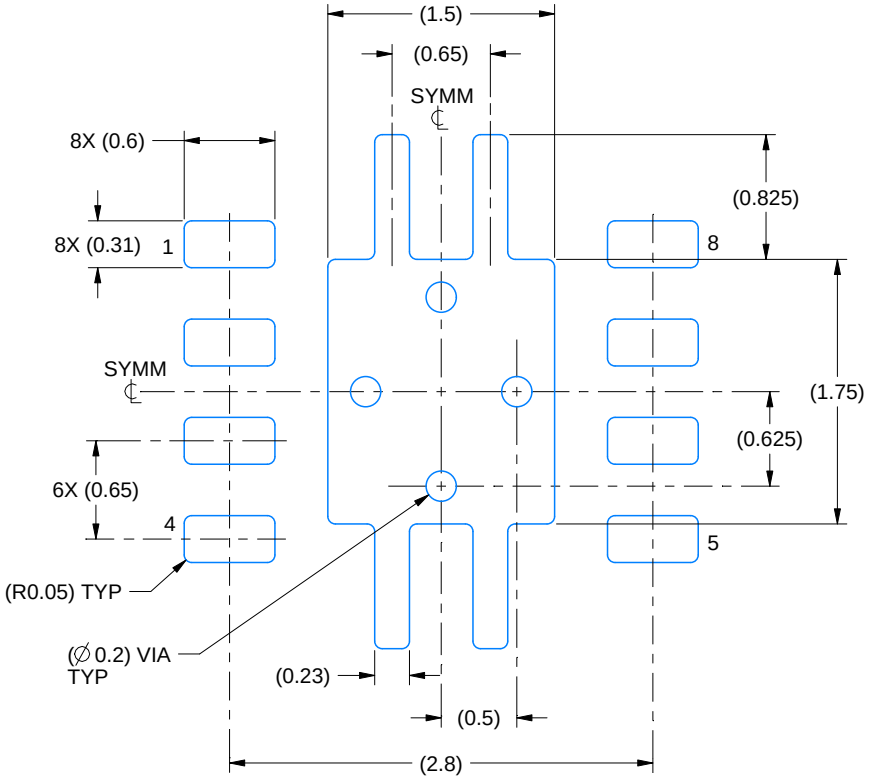
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

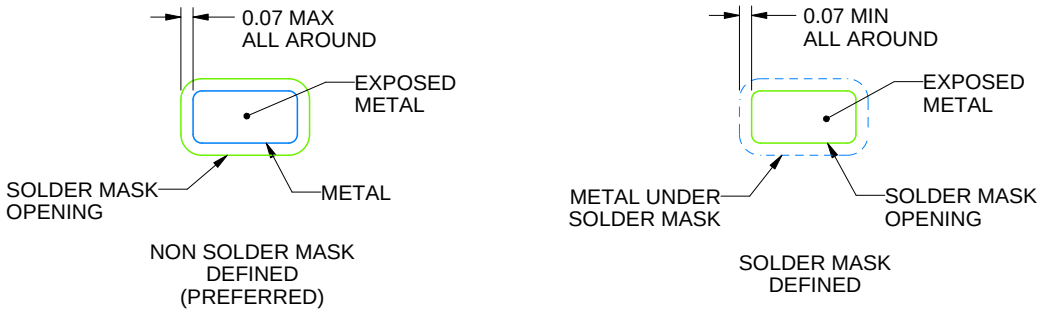
DRB0008A

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:20X

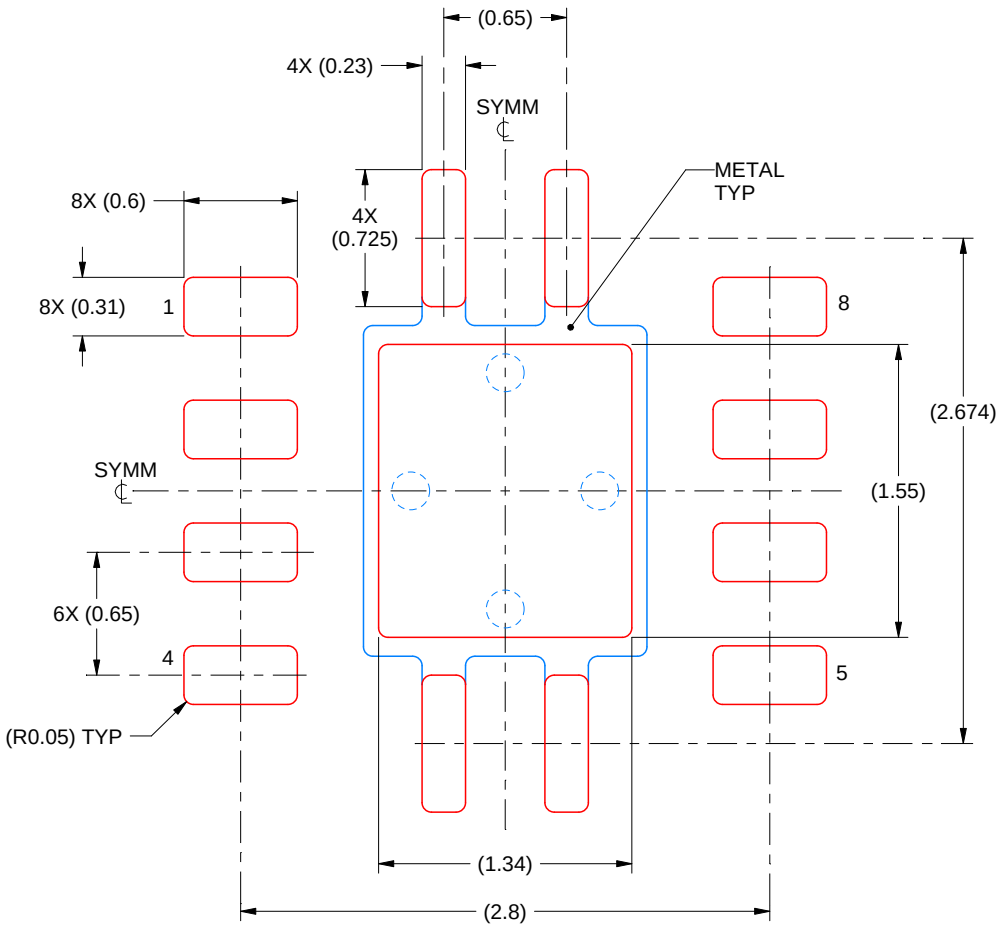


SOLDER MASK DETAILS

4218875/A 01/2018

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
84% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:25X

4218875/A 01/2018

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月